

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

PA5008us

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 7月10日

Yoji OKAZAKI, et al.

Q76477

MULTIPLEX LASER-LIGHT SOURCE AND.....

202-293-7060

Darryl Mexic

July 10, 2003

出願番号

Application Number:

特願2002-201904

[ST.10/C]:

[JP 2002-201904]

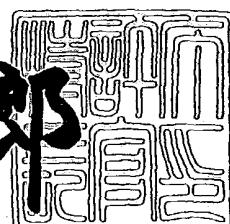
出願人

Applicant(s):

富士写真フィルム株式会社

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田 信一郎



出証番号 出証特2003-3028624

【書類名】 特許願

【整理番号】 P26924J

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 H01S 5/00

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県足柄上郡開成町宮台 798番地 富士写真フィルム株式会社内

【氏名】 岡崎 洋二

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県足柄上郡開成町宮台 798番地 富士写真フィルム株式会社内

【氏名】 永野 和彦

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県足柄上郡開成町宮台 798番地 富士写真フィルム株式会社内

【氏名】 蔵町 照彦

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【氏名又は名称】 富士写真フィルム株式会社

【代理人】

【識別番号】 100073184

【弁理士】

【氏名又は名称】 柳田 征史

【選任した代理人】

【識別番号】 100090468

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐久間 剛

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 008969

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9814441

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 合波レーザー光源および露光装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の半導体レーザーと、

1本のマルチモード光ファイバーと、

前記複数の半導体レーザーからそれぞれ出射したレーザービームを集光した上で前記マルチモード光ファイバーに結合させる集光光学系とを備えてなる合波レーザー光源において、

前記半導体レーザーとして、チップ状態のシングルキャビティ窒化物系化合物半導体レーザーが用いられ、

この半導体レーザーがサブマウントを介してCuまたはCu合金製放熱ブロック上に実装され、

前記サブマウントが、熱膨張係数が $3.5 \sim 6.0 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ である材料を用いて200~400 μm の厚さに形成され、

このサブマウントに対して前記半導体レーザーが、両者の接着面内でAuSn共晶点半田およびメタライズ層を複数に分割して、ジャンクションダウン構造で分割接着されていることを特徴とする合波レーザー光源。

【請求項2】 前記半導体レーザーの発光部の直下において、前記AuSn共晶点半田およびメタライズ層を分割する溝が設けられていることを特徴とする請求項1記載の合波レーザー光源。

【請求項3】 前記サブマウントがAlNからなることを特徴とする請求項1または2記載の合波レーザー光源。

【請求項4】 前記サブマウントが前記CuまたはCu合金製放熱ブロックに対して、AuSn共晶点半田によって接着されていることを特徴とする請求項1から3いずれか1項記載の合波レーザー光源。

【請求項5】 前記複数の半導体レーザーが、各々の活性層と平行な方向に発光点が1列に並ぶように配設され、

前記集光光学系が、前記発光点の並び方向の開口径が該方向に直角な方向の開口径よりも小さく形成されて、各半導体レーザー毎に設けられた複数のコリメー

ターレンズ、およびこれらのコリメーターレンズで平行光化された複数のレーザービームをそれぞれ集光して前記マルチモード光ファイバーの端面で収束させる集光レンズから構成されていることを特徴とする請求項1から4いずれか1項記載の合波レーザー光源。

【請求項6】 前記複数のコリメーターレンズが一体化されて、レンズアレイとして構成されていることを特徴とする請求項5記載の合波レーザー光源。

【請求項7】 前記複数の半導体レーザーを実装するブロックが複数に分割され、互いに張り合わせて一体化されていることを特徴とする請求項1から6いずれか1項記載の合波レーザー光源。

【請求項8】 前記半導体レーザーとしてGaN系半導体レーザーが用いられていることを特徴とする請求項1から7いずれか1項記載の合波レーザー光源。

【請求項9】 前記マルチモード光ファイバーとして、コア径が $50\mu\text{m}$ 以下で、NAが0.3以下のものが用いられていることを特徴とする請求項1から8いずれか1項記載の合波レーザー光源。

【請求項10】 前記マルチモード光ファイバーとして、コア径×NAの値が $10\mu\text{m}$ 以下のものが用いられていることを特徴とする請求項1から9いずれか1項記載の合波レーザー光源。

【請求項11】 前記半導体レーザーが3～10個、一列に並べて設けられていることを特徴とする請求項1から10いずれか1項記載の合波レーザー光源。

【請求項12】 前記半導体レーザーが6または7個、一列に並べて設けられていることを特徴とする請求項11記載の合波レーザー光源。

【請求項13】 前記半導体レーザーとして、発光幅が $1.5\sim 5\mu\text{m}$ のものが用いられていることを特徴とする請求項1から12いずれか1項記載の合波レーザー光源。

【請求項14】 前記半導体レーザーとして、発光幅が $2\sim 3\mu\text{m}$ のものが用いられていることを特徴とする請求項13記載の合波レーザー光源。

【請求項15】 前記複数の半導体レーザーが、レーザービームの照射を受

ける側から見た状態で2次元的に配列固定されていることを特徴とする請求項1から14いずれか1項記載の合波レーザー光源。

【請求項16】 前記マルチモード光ファイバーが複数、少なくとも出射端部において1次元アレイ状に配設され、それらのマルチモード光ファイバーの各々に前記複数の半導体レーザーおよび集光光学系が組み合わされていることを特徴とする請求項1から15いずれか1項記載の合波レーザー光源。

【請求項17】 前記マルチモード光ファイバーが複数、少なくとも出射端部においてバンドル状に配設され、それらのマルチモード光ファイバーの各々に前記複数の半導体レーザーおよび集光光学系が組み合わされていることを特徴とする請求項1から15いずれか1項記載の合波レーザー光源。

【請求項18】 請求項16または17に記載の合波レーザー光源を露光用光源として備えたことを特徴とする露光装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は合波レーザー光源に関し、特に詳細には、複数の半導体レーザーから発せられたレーザービームを光ファイバーを利用して合波する合波レーザー光源に関するものである。

【0002】

また本発明は、上述のような合波レーザー光源を露光用光源として用いる露光装置に関するものである。

【0003】

【従来の技術】

従来、紫外域のレーザービームを発生させる装置として、半導体レーザー励起固体レーザーから発せられた赤外光を紫外域の第3高調波に変換する波長変換レーザーや、エキシマレーザーや、Arレーザーが実用に供されている。

【0004】

さらには近時、例えば1998年発行のJpn.Appl.phys.Lett., Vol.37.p.L1020に示されるように、400nm近傍の波長のレーザービームを発するGaN系半導体レ

ーザーも提供されている。

【0005】

このような波長のレーザービームを発する光源は、350~420 nmの紫外領域を含んだ所定の波長域（以下「紫外域」という）に感度を有する感光材料を露光する露光装置において、露光用光源として適用することも考えられている。その場合の露光用光源は、当然ながら、感光材料を感光させるのに十分な出力を備えることが求められる。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

しかし上記エキシマレーザーは、装置が大型で、コストやメンテナンスコストも高いという問題がある。

【0007】

また、赤外光を紫外域の第3高調波に変換する波長変換レーザーは、波長変換効率が非常に低いことから、高出力を得るのは極めて困難になっている。現在のところは、30Wの半導体レーザーで固体レーザー媒質を励起して10Wの基本波（波長1064 nm）を発振させ、それを3 Wの第2高調波（波長532 nm）に変換し、それら両者の和周波である1 Wの第3高調波（波長355 nm）を得る、というのが現在の実用レベルである。その場合の半導体レーザーの電気-光効率は50%程度であり、そして紫外光への変換効率は1.7%程度と非常に低いものとなっている。そしてこのような波長変換レーザーは、高価な光波長変換素子を用いるために、コストがかなり高いものとなっている。

【0008】

またArレーザーは電気-光効率が0.005%と非常に低く、寿命が1000時間程度と非常に短いという問題がある。

【0009】

一方、GaN系半導体レーザーについては、低転位のGaN結晶基板が得られないことから、ELOGという成長方法によって約5 μm程度の低転位領域を作り出し、その上にレーザー領域を形成して高出力化と高信頼性を実現する試みがなされている。しかし、こうして作製されるGaN系半導体レーザーにおいても

、大面積に亘って低転位の基板を得るのが難しいので、500mW～1W級の高出力なものは未だ商品化されていない。

【0010】

また、半導体レーザーの高出力化の別の試みとして、例えば1つで100mWの光を出力するキャビティを100個形成することで10Wの出力を得るようなことも考えられているが、100個程度の多数のキャビティを高歩留まりで作成することは、ほとんど現実性が無いと言える。特に、シングルキャビティの場合でも99%以上の高歩留まり化は困難であるGaN系半導体レーザーにあっては、なおさらである。

【0011】

本発明は上記の事情に鑑み、高出力が得られる低コストの合波レーザー光源を提供することを目的とする。

【0012】

また本発明は、上述のような合波レーザー光源を用いることにより、高強度のレーザー光で感光材料を露光可能な露光装置を提供することを目的とする。

【0013】

【課題を解決するための手段】

本発明による合波レーザー光源は、

複数の半導体レーザーと、

1本のマルチモード光ファイバーと、

前記複数の半導体レーザーからそれぞれ出射したレーザービームを集光した上で前記マルチモード光ファイバーに結合させる集光光学系とを備えてなる合波レーザー光源において、

前記半導体レーザーとして、チップ状態のシングルキャビティ窒化物系化合物半導体レーザーが用いられ、

この半導体レーザーがサブマウントを介してCuまたはCu合金製放熱ブロック上に実装され、

前記サブマウントが、熱膨張係数が $3.5\sim6.0\times10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ である材料を用いて200～400 μm の厚さに形成され、

このサブマウントに対して前記半導体レーザーが、両者の接着面内でAuSn共晶点半田およびメタライズ層を複数に分割して、ジャンクションダウン構造で分割接着されていることを特徴とするものである。

【0014】

なお上記窒化物系化合物半導体レーザーとしてはGaN系半導体レーザー素子が好適に用いられ、その場合は前記サブマウントがAlNから形成されることが望ましい。

【0015】

また上記のサブマウントも前記CuまたはCu合金製放熱ブロックに対して、AuSn共晶点半田によって接着されていることが望ましい。

【0016】

なお上述の構成においては、

複数の半導体レーザーが、各々の活性層と平行な方向に発光点が1列に並ぶように配設され、

集光光学系が、前記発光点の並び方向の開口径が該方向に直角な方向の開口径よりも小さく形成されて、各半導体レーザー毎に設けられた複数のコリメーターレンズ、およびこれらのコリメーターレンズで平行光化された複数のレザービームをそれぞれ集光して前記マルチモード光ファイバーの端面で収束させる集光レンズから構成されていることが望ましい。

【0017】

また、上記複数のコリメーターレンズは互いに一体化されて、レンズアレイとして構成されることが望ましい。

【0018】

他方、上記複数の半導体レーザーを実装するブロックは、複数に分割され、互いに張り合わせて一体化されていることが望ましい。

【0019】

また複数の半導体レーザーは、一列に並べて配置する場合には3~10個、さらに好ましくは6または7個設けられることが望ましい。またこの半導体レーザーとしては、発光幅が1.5~5μm、さらに好ましくは2~3μmのものが用い

られるのが望ましい。そしてこの半導体レーザーとしては、GaN系半導体レーザーが用いられることが望ましい。

【0020】

一方上記マルチモード光ファイバーとしては、コア径が $50\mu\text{m}$ 以下で、NA（開口数）が0.3以下のものが用いられることが望ましい。さらに、このマルチモード光ファイバーとしては、コア径×NAの値が $7.5\mu\text{m}$ 以下のものが用いられることが望ましい。

【0021】

また本発明の合波レーザー光源において、複数の半導体レーザーは、レーザービームの照射を受ける側から見た状態で2次元的に配列固定されて、マルチモード光ファイバーへの光入力をより高くする構造となっていることが望ましい。

【0022】

本発明の合波レーザー光源は、上述したマルチモード光ファイバーを1本だけ用いて構成されてもよいが、好ましくは、該マルチモード光ファイバーを複数用いて、それらのマルチモード光ファイバーの各々に複数の半導体レーザーおよび集光光学系を組み合わせ、各マルチモード光ファイバーから高出力のレーザービームを発するように構成することもできる。そのようにする場合、複数のマルチモード光ファイバーは少なくとも出射端部において1次元アレイ状、あるいは、バンドル状に配設されるのが望ましい。

【0023】

本発明による露光装置は、上記のように複数のマルチモード光ファイバーが1次元アレイ状、あるいは、バンドル状に配設されてなる本発明の合波レーザー光源を露光用光源として備えたことを特徴とするものである。

【0024】

【発明の効果】

本発明の合波レーザー光源は、複数の半導体レーザーからそれぞれ出射したレーザービームを集光してマルチモード光ファイバーに結合させる極めて簡単な構成のものであって、特に作製が困難な要素も必要としないので、低コストで形成可能となる。

【0025】

それに加えて本発明の合波レーザー光源は、コストが低く熱伝導性も高いCuまたはCu合金から形成された放熱ブロックを用いているので、半導体レーザーが発する熱を良好に放熱することができ、そして安価に作製可能となる。

【0026】

また本発明の合波レーザー光源は、サブマウントに対して半導体レーザーがジヤンクションダウン構造で固定されていることにより、半導体レーザーの基板側をサブマウントに固定する場合と比べて該レーザーの発光部がサブマウントに、ひいては放熱ブロックに対してより近接して位置するので、この点からも良好に放熱がなされるものとなる。また、サブマウントの厚み調整はチップ基板の厚み調整よりも容易にできることからサブマウントの厚み精度を1μm以下として、さらにチップをジヤンクションダウン構造で実装することで、チップ毎の発光点高さバラツキも抑制することができるので、光ファイバーへの高効率結合も可能となる。

【0027】

またAuSn共晶点半田は経時位置変化特性に優れているので、それにより半導体レーザーとサブマウントとが接着されている本発明の合波レーザー光源は、半導体レーザーの発光点位置の経時的変動を効果的に抑制できるものとなる。

【0028】

さらに本発明の合波レーザー光源においては、サブマウントが、熱膨張係数が $3.5 \sim 6.0 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ である材料を用いて200~400μmの厚さに形成されていることにより、半田接着時の熱歪によって半導体レーザーが劣化することも防止可能となる。その理由については、後に示す本発明の実施の形態に沿って詳しく説明する。

【0029】

さらに本発明の合波レーザー光源は、サブマウントと半導体レーザーの両者の接着面内でAuSn共晶点半田が複数に分割されているので、この接着部で発生する応力を小さく抑えることも可能となっている。

【0030】

また本発明の合波レーザー光源において、特に複数の半導体レーザーが、各々の活性層と平行な方向に発光点が1列に並ぶように配設され、集光光学系が、前記発光点の並び方向の開口径が該方向に直角な方向の開口径よりも小さく形成されて、各半導体レーザー毎に設けられた複数のコリメーターレンズ、およびこれらのコリメーターレンズで平行光化された複数のレーザービームをそれぞれ集光して前記マルチモード光ファイバーの端面で収束させる集光レンズから構成された場合には、複数の半導体レーザーの配置ピッチをより短くして、より高密度に配置できるようになる。このように複数の半導体レーザーをより高密度に配置しておくと、複数のレーザービームの光ファイバー端面における位置ずれがより小さく抑えられるようになるので、複数の半導体レーザー、マルチモード光ファイバーおよび集光光学系の組立位置精度を比較的緩くできるという効果が得られ、さらに、この組立位置精度を緩くできることから、合波本数をより多くして高出力化できる。その理由は、後に実施の形態に沿って詳しく説明する。

【0031】

また、上述のような複数のコリメーターレンズが互いに一体化されてレンズアレイとして構成される場合は、複数のコリメーターレンズが1個ずつ別体に形成される場合と比較して、各レンズの周辺部に大きな非有効領域ができてしまうことを避けられるから、各レンズを互いにより近接させて配置可能となる。そうであれば、複数の半導体レーザーをよりさらに高密度に配置できるので、上記の組立位置精度を緩くできるという効果、合波本数をより多くして高出力化できるという効果がさらに顕著なものとなる。

【0032】

さらにこの場合は、コリメーターレンズの位置調整作業が、1つのレンズアレイの位置を調整するだけで済むので、この作業が簡素化される。

【0033】

また、印刷、医用画像の分野や、P C B (プリント・サーキット・ボード)、P D P (プラズマディスプレイ)、L C D (液晶ディスプレイ) 等による画像を感光材料に露光する場合等においては、上記マルチモード光ファイバーとしてコア径が $50 \mu m$ 以下のものを用いると、露光スポットを微細なものにして高精細な

画像を露光できるようになる。また、そのマルチモード光ファイバーのNAが0.3以下であると、上述のような高精細画像を露光する上で十分な焦点深度が確保され、鮮鋭度の高い画像を露光可能となる。

【0034】

また、マルチモード光ファイバーとしてコア径×NAの値が $10\mu\text{m}$ 以下のものを用いる場合、それらの組合せとしては例えば $50\mu\text{m} \times 0.2$ 、 $40\mu\text{m} \times 0.25$ 、 $30\mu\text{m} \times 0.3$ 、 $25\mu\text{m} \times 0.3$ 等が挙げられる。なおここでは、光ファイバーのNAが0.3を超えるとその作成が難しくなるので、上記の値としている。このような特性のマルチモード光ファイバーを用いると、そのNAと同程度のNAのコリメーターレンズで各半導体レーザーからのレーザービームを平行光化でき、NA=0.3の集光レンズで $25\mu\text{m}$ 以下のスポットに合波レーザービームを集光させることも可能になる。それにより、高解像度と十分な焦点深度を確保できるようになる。

【0035】

他方、上記複数の半導体レーザーを実装するブロックが複数に分割され、互いに張り合わせて一体化されている場合は、1つのブロックに半導体レーザーを全て実装する場合と比較して、実装の歩留まりを向上させることができる。例えば、1つの半導体レーザーの実装歩留まりが98%の場合、6個の半導体レーザーを1つのブロックに全て実装する場合の全体の実装歩留まりは $86\% (=0.98^6 \times 100)$ であり、それに対して3個ずつ2つのブロックに実装する場合のそれは、2つのブロックを接合する歩留まりはほぼ100%を実現できるので、94% $(=0.98^3 \times 100)$ に向上する。

【0036】

また本発明の合波レーザー光源において、半導体レーザーが3個以上設けられれば、従来知られている偏光合波では2個の半導体レーザーからのレーザービームしか合波できないのに対し、それを上回る高出力の合波ビームを得ることが可能になる。ただし、1つの半導体レーザーの実装歩留まりが通常その程度であるように98%であるとすると、半導体レーザーを10個設ける場合には、実装歩留まりが82%まで低下する。それ以上の歩留まり低下は現実上避けなければなら

ないないので、本発明の好ましい実施の形態においては、この半導体レーザーの数の上限を10個とする。

【0037】

さらに、半導体レーザーの数が10個一列に並べて配置される場合、画像形成用のコア径 $50\mu\text{m}$ 以下でNA0.3以下、もしくはコア径×NA=10 μm 以下のマルチモード光ファイバーを用いたとき、求められる実装精度は $0.1\mu\text{m}$ 未満と非常に厳しい値になってしまふが、一列に並べる半導体レーザーの数を6または7個としておくことにより、求められる実装精度は $0.3\sim 1\mu\text{m}$ 未満と著しく緩和される。また、半導体レーザーの数が6または7個の場合は、3個の場合と比べて2倍以上の高出力を得ることができる。

【0038】

また半導体レーザーとして発光幅が $1.5\mu\text{m}$ 以上のものを適用することにより、例えそれがGaN系半導体レーザーである場合は、完全単一横モード構造のものの最大出力(30mW程度)と比較して、高い出力(50mW以上)を得ることができる。一方、半導体レーザーとして発光幅が $5\mu\text{m}$ 以下のものを適用することにより、画像形成用のコア径 $50\mu\text{m}$ 以下でNA0.3以下、もしくはコア径×NA=10 μm 以下のマルチモード光ファイバーに対して半導体レーザーが3個以上の集光結合系を構成可能となる。また、半導体レーザーとして発光幅が $2\sim 3\mu\text{m}$ のものを適用することにより、前記の画像形成用の光学系において半導体レーザーが6または7個の集光結合系を構成可能となる。

【0039】

また複数の半導体レーザーを、レーザービームの照射を受ける側から見た状態で2次元的に配列すれば、多数の半導体レーザーを高密度に配置できるから、1本のマルチモード光ファイバーにより多数のレーザービームを入射させることができ可能となって、より高出力の合波レーザービームを得ることができる。

【0040】

他方、本発明の合波レーザー光源が、複数のマルチモード光ファイバーを少なくとも出射端部において1次元アレイ状、あるいはバンドル状に配設してなる場合は、それらの光ファイバーから高出力のレーザービームを1次元あるいは2次

元に整列した状態で出射させることができる。そうであれば、整列して出射する複数のレーザービームの各々を、変調部がライン状、あるいは2次元状に配列されてなるGLVやDMD等の空間光変調素子の各変調部に入射させて、画像露光等のために効率良く変調させることができる。

【0041】

そこで、上述のように構成された合波レーザー光源を露光用光源として用いる本発明の露光装置は、上記空間光変調素子を併せて用いて、2次元に整列して出射するレーザービームをそのまま感光材料に2次元状に照射することにより、あるいは1次元あるいは2次元に整列して出射するレーザービームを感光材料に照射するとともに感光材料をレーザービームに対して相対的に副走査移動させることにより、該感光材料に2次元画像を露光可能なものとなる。

【0042】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。

【0043】

図1は、本発明の第1の実施の形態による合波レーザー光源の平面形状を示すものである。図示されるようにこの合波レーザー光源は、銅からなるヒートブロック（放熱ブロック）10上にサブマウント9を介して配列固定された一例として7個のチップ状態の横シングルモードシングルキャビティGaN系半導体レーザーLD1, LD2, LD3, LD4, LD5, LD6およびLD7と、各GaN系半導体レーザーLD1, LD2, LD3, LD4, LD5, LD6およびLD7に対してそれぞれ設けられたコリメーターレンズ11, 12, 13, 14, 15, 16および17と、1つの集光レンズ20と、1本のマルチモード光ファイバー30とから構成されている。

【0044】

なおこの図1は、本実施の形態の合波レーザー光源の基本構成を示すものであり、コリメーターレンズ11～17および集光レンズ20の形状は概略的に示してある。また、それらの取付状態の詳細については後に説明する。なお、ヒートブロック10に対するサブマウント9およびGaN系半導体レーザーLD1～7の取付状

態を、2つのGaN系半導体レーザーLD6, 7で代表させて図2に示す。この図2には示していない残りのGaN系半導体レーザーLD1~5についてもこれと同様である。GaN系半導体レーザーLD1~7の実装に関しては、後に詳しく述べる。

【0045】

GaN系半導体レーザーLD1~7は、発振波長が例えば全て共通の405nmであり、最大出力も全て共通の30mWである。これらのGaN系半導体レーザーLD1, LD2, LD3, LD4, LD5, LD6およびLD7から発散光状態で出射したレーザービームB1, B2, B3, B4, B5, B6およびB7は、それぞれコリメーターレンズ11, 12, 13, 14, 15, 16および17によって平行光化される。

【0046】

平行光とされたレーザービームB1~7は、集光レンズ20によって集光され、マルチモード光ファイバー30のコア30aの入射端面上で収束する。本例ではコリメーターレンズ11~17および集光レンズ20によって集光光学系が構成され、それとマルチモード光ファイバー30とによって合波光学系が構成されている。すなわち、集光レンズ20によって上述のように集光されたレーザービームB1~7がこのマルチモード光ファイバー30のコア30aに入射してそこを伝搬し、1本のレーザービームBに合波されてマルチモード光ファイバー30から出射する。なおマルチモード光ファイバー30としては、ステップインデックス型のもの、グレーディングインデックス型のもの、およびそれらの複合型のものが全て適用可能である。

【0047】

次に、この合波レーザー光源からなる紫外光高輝度合波ファイバーモジュールについて詳しく説明する。図3、4および5はそれぞれ、この紫外光高輝度合波ファイバーモジュールの平面形状、側面形状および部分正面形状を示すものである。なおこれらの図では、コリメーターレンズ11~17および集光レンズ20の形状や取付状態を詳しく示してある。

【0048】

本例においてモジュールを構成する光学要素は、上方が開口した箱状のパッケ

ージ40内に収容され、このパッケージ40の上記開口がパッケージ蓋41によって閉じられることにより、該パッケージ40およびパッケージ蓋41が画成する閉空間内に密閉保持される。

【0049】

パッケージ40の底面にはベース板42が固定され、このベース板42の上面に前記ヒートブロック10が取り付けられ、そしてこのヒートブロック10にコリメーターレンズ11～17を保持するコリメーターレンズホルダ44が固定されている。さらにベース板42の上面には、集光レンズ20を保持する集光レンズホルダ45と、マルチモード光ファイバー30の入射端部を保持するファイバーホルダ46が固定されている。またGaN系半導体レーザーLD1～7に駆動電流を供給する配線類47は、パッケージ40の横壁面に形成された開口を通してパッケージ外に引き出されている。

【0050】

なお図3においては、図の煩雑化を避けるために、GaN系半導体レーザーLD1～7のうち1つのGaN系半導体レーザーLD7にのみ番号を付し、同様にコリメーターレンズ11～17のうち1つのコリメーターレンズ17にのみ番号を付してある。

【0051】

図5は、上記コリメーターレンズ11～17の取付部分の正面形状を示すものである。ここに示されるように各コリメーターレンズ11～17は、非球面円形レンズの光軸を含む領域を細長く切り取った形とされたものであり、例えば樹脂あるいは光学ガラスをモールド成形することによって形成される。図6の(1)および(2)にはそれぞれ、それらを代表して1つのコリメーターレンズ17の拡大側面形状および正面形状を、要部の寸法(単位はmm)も入れて示してある。

【0052】

図5および6に示される通りコリメーターレンズ11～17は、GaN系半導体レーザーLD1～7の発光点の並び方向(図5の左右方向)の開口径が該方向に直角な方向(図5の上下方向)の開口径よりも小さく形成されて、上記発光点の並び方向に密接配置されている。

【0053】

一方GaN系半導体レーザーLD1～7としては、発光幅が約 $1\text{ }\mu\text{m}$ で、活性層と平行な方向、直角な方向の拡がり角が一例としてそれぞれ 10° 、 30° の状態で各々レーザービームB1～7を発するものが用いられている。これらのGaN系半導体レーザーLD1～7は、活性層と平行な方向に発光点が1列に並ぶよう配設されている。

【0054】

したがって、各発光点から発せられたレーザービームB1～7は、上述のように細長い形状とされた各コリメーターレンズ11～17に対して、拡がり角最大の方向が開口径大の方向と一致し、拡がり角最小の方向が開口径小の方向と一致する状態で入射することになる。つまり、細長い形状とされた各コリメーターレンズ11～17は、入射するレーザービームB1～7の楕円形の断面形状に対応して、非有効部分を極力少なくして使用されることになる。本実施の形態では具体的に、コリメーターレンズ11～17の開口径は水平方向、垂直方向で各々 1.1 mm 、 4.6 mm であり、それらに入射するレーザービームB1～7の水平方向、垂直方向のビーム径は各々 0.9 mm 、 2.6 mm である。また、コリメーターレンズ11～17の各焦点距離 $f_1 = 3\text{ mm}$ 、 $\text{NA} = 0.6$ 、レンズ配置ピッチ $= 1.25\text{ mm}$ である。

【0055】

また図7の(1)および(2)はそれぞれ、集光レンズ20の拡大側面形状および正面形状を、要部の寸法(単位はmm)も入れて示すものである。ここに示されるように集光レンズ20も、非球面円形レンズの光軸を含む領域を細長く切り取って、コリメーターレンズ11～17の並び方向つまり水平方向に長く、それと直角な方向に短い形状とされている。そして該集光レンズ20の焦点距離 $f_2 = 23\text{ mm}$ 、 $\text{NA} = 0.2$ である。この集光レンズ20も、例えば樹脂あるいは光学ガラスをモールド成形することによって形成される。

【0056】

他方、マルチモード光ファイバー30としては、三菱電線工業株式会社製のステップインデックス型光ファイバーを基本として、コア径 $= 50\text{ }\mu\text{m}$ 、 $\text{NA} = 0.2$ 、端面コートの透過率 $= 99.5\%$ 以上のものが用いられている。本例の場合、先に述

べたコア径×NAの値は10μmである。

【0057】

本実施の形態の構成においては、レーザービームB1～7のマルチモード光ファイバー30への結合効率が0.9となる。したがって、GaN系半導体レーザーLD1～7の各出力が30mWのときには、出力190mW (=30mW×0.9×7) の合波レーザービームBが得られることになる。

【0058】

以上説明した紫外光高輝度合波ファイバーモジュールは図8に示すように、マルチモード光ファイバー30の出射端部を1次元アレイ状に配設して、それらのマルチモード光ファイバー30の各々から高輝度の紫外レーザービームBを射出する光源装置を構成することができる。具体的には、出力190mWの合波レーザービームBを出射させるマルチモード光ファイバー30を53本並べることで、10Wもの超高出力でかつ高光密度 {10W / (125μm × 53本) = 1.5W / mm} を実現でき、エネルギー効率もGaN系半導体レーザーの発光効率と同等のほぼ15%という高い値を実現できる。同様の構成にて、横マルチモードの出力100mWの半導体レーザーを用いることで、ファイバー出力630mWが得られ、高光密度 {10W / (125μm × 16本) = 5W / mm} を実現できる。

【0059】

また、上記マルチモード光ファイバー30の出射端部をバンドル状に配設して、光源装置を構成することも可能である。そのような光源装置は、1次元あるいは2次元空間光変調素子と組み合わせて、画像露光装置に好適に利用され得るものとなる。そのような画像露光装置については、後に詳しく説明する。

【0060】

次に図17および18を参照して、サブマウント9を用いたGaN系半導体レーザーLD1～7の実装について詳しく説明する。図17は、窒化物系化合物半導体レーザーであるGaN系半導体レーザーLD1～7のうちの1つのGaN系半導体レーザーLD1が、Cu放熱ブロック10上に実装された状態を示す正面図である。なおここでは1つのGaN系半導体レーザーLD1に代表させて実装を説明するが、これは他のGaN系半導体レーザーLD2～7に関しても同様である。

る。

【0061】

まず図18に示すように、AlNサブマウント9の下表面にAu/Pt/Tiメタライズ層504が形成され、またその上表面にはAu/Niメッキ層505および段差を有するAu/Pt/Tiメタライズ層506が形成される。ここで、本発明でいうところのサブマウントの厚さは、上記各層504~506は含まない厚さ、つまり図18のd寸法である。

【0062】

上記のように段差を有するAu/Pt/Tiメタライズ層506は、例えば一様に厚く該メタライズ層506を形成した後、低くする部分をイオンミリングのようなドライプロセスあるいはエッチャントによるウェットプロセスによって除去する方法や、さらには、低くする方の層の高さ分だけメタライズした後、低くする部分をマスキングした上で再度メタライズする方法等を適用して形成することができる。

【0063】

次いでAu/Pt/Tiメタライズ層506の高い部分と低い部分に、それぞれパッド状の共晶点AuSn半田507, 507を配置する。これらのパッド状共晶点AuSn半田507, 507は例えば $150 \times 500 \mu\text{m}$ の大きさに形成され、互いに例えば $10 \mu\text{m}$ の間隔を置いて配置される。そしてこれらの共晶点AuSn半田507, 507の上に、一例として概略 $400 \times 600 \times 100 \mu\text{m}$ のサイズのチップ状GaN系半導体レーザーLD1を配置し、 330°C に加熱して共晶点AuSn半田507, 507を融解させることにより、該GaN系半導体レーザーLD1をAlNサブマウント9に接着固定する。

【0064】

次いで、上表面にAu/Niメッキ層508およびAu/Pt/Tiメタライズ層509が形成されているCu放熱ブロック10の上に共晶点AuSn半田511を配置し、その上にAu/Pt/Tiメタライズ層504を下にしてAlNサブマウント9を配置し、 310°C に加熱して共晶点AuSn半田511を融解させることにより、AlNサブマウント9をCu放熱ブロック10に接着固定する。以上により、GaN

N系半導体レーザーLD1がAlNサブマウント9を介してCu放熱ブロック10に実装される。

【0065】

なおAuSn半田の融解点はAuとSnとの組成比に応じて変化する。そこで、AlNサブマウント9のAu/Pt/Tiメタライズ層506および504の膜厚を互いに独立に制御するとともに、共晶点AuSn半田507および511の融解時の温度を制御することにより、共晶点AuSn半田507が融解した後の状態、共晶点AuSn半田511が融解した後の状態における各Au組成比を共晶点組成より数%程度高い組成にすることで、共晶点AuSn半田507および511の融解後の融解温度に差を持たせることができる。

【0066】

このような融解温度差を生じさせることにより、AlNサブマウント9にGaN系半導体レーザーLD1を接着する時と、AlNサブマウント9をCu放熱ブロック10に接着する時とで同じ共晶点AuSn半田を用いても、互いに融解温度差を付けて（後者の接着時の方が低い）実装することが可能となる。そうであれば、発光点位置が経時的に変動しやすい低融点半田を用いなくて済むので、発光点位置変動を抑える上で有利となる。

【0067】

また本実施の形態においてGaN系半導体レーザーLD1は、Al₂O₃からなる基板側が上に位置する向きに配置され、素子形成面側（pn接合側）がCu放熱ブロック10に固定されて、いわゆるジャンクションダウン構造で実装がなされる。

【0068】

またこの構造において、GaN系半導体レーザーLD1の発光点は、図17において概略Qで示す位置にある。そして共晶点AuSn半田507、Au/Pt/Tiメタライズ層506およびAu/Niメッキ層505には、それらを分割する溝512が形成され、GaN系半導体レーザーLD1はその発光部の直下に上記溝512が位置するように接着される。つまり、GaN系半導体レーザーLD1の発光部は直接サブマウント側に接着しないので、さらなる応力低減が実現される。また上

記の溝512が形成されていれば、GaN系半導体レーザーLD1の発光端面がAlNサブマウント9の端面より内側に位置する場合でも、発光ビームがAlNサブマウント9によってケラレることを防止できる。

【0069】

なおGaN系半導体レーザーLD1のn側電極を、Au/Pt/Tiメタライズ層506の高い部分に対面する位置に形成するとともに、Au/Pt/Tiメタライズ層506の高い部分と低い部分とを互いに絶縁された状態に形成して、それらの両部分にそれぞれn側電極、p側電極を導通させるようにしてもよい。

【0070】

本実施の形態では、コストが低く熱伝導性も高いCuから形成された放熱ブロック10を用いているので、GaN系半導体レーザーLD1が発する熱を良好に放熱することができ、そして安価に作製可能となる。

【0071】

また本実施の形態の合波レーザー光源では、AlNサブマウント9に対してGaN系半導体レーザーLD1がジャンクションダウン構造で固定されていることにより、GaN系半導体レーザーLD1の基板側をAlNサブマウント9に固定する場合と比べて該GaN系半導体レーザーLD1の発光部がサブマウント9に、ひいては放熱ブロック10に対してより近接して位置するので、この点からも良好に放熱がなされるものとなる。

【0072】

またAuSn共晶点半田507は経時位置変化特性に優れているので、それによりGaN系半導体レーザーLD1とAlNサブマウント9とが接着されている本実施の形態の合波レーザー光源は、GaN系半導体レーザーLD1の発光点位置の経時的変動を効果的に防止できるものとなる。

【0073】

図10のaは、上記のように実装されたGaN系半導体レーザーLD1を-40～80℃の条件下で経時試験にかけた際の、発光点位置の上下方向移動量を測定した結果を示すものである。なお同図の横軸は半田材質による発光点位置移動量の正規確率分布(%)を示し、縦軸が発光点位置の移動量を示している。また、A

u S n 共晶点半田507に代えて低融点半田を用いた場合の発光点位置の移動量を、同図中に b で示してある。ここに示されている通り、本実施の形態における G a N 系半導体レーザー L D 1 では、低融点半田を用いたものと比較して、発光点位置移動量が極めて少なく抑えられている。

【0074】

次に図19は、G a N 系半導体レーザー L D 1 を実装した際に熱歪によって G a N 系半導体レーザー L D 1 の発光点に作用する応力が、サブマウントの熱膨張係数に応じてどのように変化するかを、計算機によるシミュレーションで求めた結果を示すものである。このシミュレーションに際しては、A l N サブマウント 9、C u 放熱ブロック 10、A u / P t / T i メタライズ層 504、506 および 509、A u / N i メッキ層 505 および 508、共晶点 A u S n 半田 507 および 511 に加えて、G a N 系半導体レーザー L D 1 の基板、下部クラッド層、発光層、上部発光層、絶縁膜の全てについて厚さ、熱膨張係数（A l N サブマウント 9 の熱膨張係数は除く）およびヤング率を求め、それらの数値を使用した。

【0075】

図19に示される通り、サブマウントの熱膨張係数が $3.5 \sim 6.0 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ の範囲にある場合は上記応力が約 32 M P a 以下と、G a N 系半導体レーザー L D 1 を実使用する上で特に問題の無い範囲に抑えられる。この点に鑑みて本発明では、サブマウントを熱膨張係数が $3.5 \sim 6.0 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ の範囲にある材料から形成するものである。

【0076】

また、サブマウントの熱膨張係数が $4.0 \sim 5.4 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ の範囲にあれば、上記応力は約 29.5 M P a 以下となるのでより好ましく、サブマウントの熱膨張係数が $4.4 \sim 4.8 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ の範囲にあれば、上記応力はほぼ 28 M P a となるのでさらに好ましい。本実施の形態でサブマウントに用いている A l N の熱膨張係数は $4.5 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ であり、上記の最も好ましい範囲にある。

【0077】

また図20は、G a N 系半導体レーザー L D 1 を実装した際に熱歪によって G a N 系半導体レーザー L D 1 の発光点に作用する応力が、該 A l N サブマウント

9の厚さに応じてどのように変化するかを、同様に計算機によるシミュレーションで求めた結果を示すものである。このシミュレーションに際しても、AlNサブマウント9、Cu放熱ブロック10、Au/Pt/Tiメタライズ層504、506および509、Au/Niメッキ層505および508、共晶点AuSn半田507および511に加えて、GaN系半導体レーザーLD1の基板、下部クラッド層、発光層、上部発光層、絶縁膜の全てについて厚さ、熱膨張係数およびヤング率を求め、それらの数値を使用した。

【0078】

図20に示される通り、AlNサブマウント9の厚さが200~400μmの範囲にある場合は上記応力が約34MPa以下と、GaN系半導体レーザーLD1を実使用する上で特に問題の無い範囲に抑えられる。この値を超える応力がGaN系半導体レーザーLD1の発光点に作用すると、そこに応力が発生しやすくなる。この点に鑑みて本発明では、サブマウントの厚さを200~400μmの範囲に設定するものである。また、AlNサブマウント9の厚さが250~350μmの範囲にあれば、上記応力は約32MPa以下となるのでより好ましい。

【0079】

なおAlNサブマウント9は、Cu放熱ブロック10から大きな圧縮応力を受ける。AlNサブマウント9はGaN系半導体レーザーLD1からの圧縮応力も受けるが、それは一般にはCu放熱ブロック10から受ける圧縮応力よりも小さいものとなっている。

【0080】

本発明の合波レーザー光源のように、複数の半導体レーザーからそれぞれ出射したレーザービームを集光した上でマルチモード光ファイバーに結合させる構成においては、発光点位置の経時的変動が有ると、それによって結合効率が低下してしまう。そこで、発光点位置の経時的変動を前述の通りにして抑制できれば、結合効率が低下することを防止できる。

【0081】

次に、図9を参照して本発明の第2の実施の形態による合波レーザー光源について説明する。なおこの図9において、図1中の要素と同等の要素には同番号を

付してあり、それらについての説明は特に必要のない限り省略する。

【0082】

この第2の実施の形態の合波レーザー光源は、図1に示した合波レーザー光源と比べると、個別に形成された7個のコリメーターレンズ11~17に代えて、7つのレンズ要素50aを有するコリメーターレンズアレイ50が用いられた点が基本的に異なるものである。そしてGaN系半導体レーザーLD1~7の実装は、先に説明した第1の実施の形態と同様になされる。

【0083】

前述した通りの形状とされた7個のコリメーターレンズ11~17を用いる場合も、それらを互いに密接配置して、GaN系半導体レーザーLD1~7の配置ピッチを小さくし、空間利用効率を高めることができるが、上述のコリメーターレンズアレイ50を用いることにより、その効果をより一層高めることが可能である。また、そのようにして空間利用効率が高められると、GaN系半導体レーザーLD1~7、集光光学系およびマルチモード光ファイバー30の組立位置精度を比較的緩くできるという効果も得られる。以下、その理由について詳しく説明する。

【0084】

図9の中に示すように、コリメーターレンズアレイ50の各レンズ要素50aの（図1の構成においては各コリメーターレンズ11~17の）焦点距離および開口数をそれぞれ f_1 、 NA_1 、集光レンズ20の焦点距離を f_2 、マルチモード光ファイバー30の開口数を NA_2 、空間利用効率を η とする。なおこの空間利用効率 η は、レーザービームB1と~レーザービームB7とで挟まれる空間中で、7本のレーザービームB1~7の光路が占める割合で規定するものであり、図9の場合のように7本のレーザービームB1~7の光路が互いに完全密接する状態が $\eta = 1$ である。

【0085】

上記の条件下では、レンズ系の倍率 a 、つまりGaN系半導体レーザーLD1~7の各発光点におけるビームスポット径に対する、マルチモード光ファイバー30のコア端面上におけるビームスポット径の比は下式で与えられる。なお N は合波本数である。

【0086】

【数1】

$$a = \frac{f_2}{f_1} = \frac{\frac{NA_1}{N}}{\left(\frac{NA_2 \times \eta}{N} \right)} = \frac{NA_1}{NA_2} \times \eta$$

この式から明らかな通り、空間利用効率 η がより大きいほど倍率Mは低下する。そして倍率aがより小さいほど、GaN系半導体レーザーLD1～7、集光光学系およびマルチモード光ファイバー30の相対位置関係がずれた際に、レーザービームB1～7がマルチモード光ファイバー30のコア端面上で動く距離が小さくなる。そこで、GaN系半導体レーザーLD1～7、集光光学系およびマルチモード光ファイバー30の組立位置精度を比較的緩くしておいても、レーザービームB1～7をマルチモード光ファイバー30のコア30aに正常に入射させることができになる。このように組立位置精度を緩くできれば、さらに合波本数を増やすことも可能になり、高出力化できる。これは、上記空間利用効率 η が大きいと倍率Mが低下することにより、合波本数を増やすことで倍率Mが増大することを補つて、合波本数を多く設定できるからである。

【0087】

以上、合波本数を7本とした2つの実施の形態について説明したが、本発明の合波レーザー光源における合波本数はこの7本に限られるものではなく、2本以上のいずれの数が選択されてもよい。ただし好ましい合波本数は、先に述べた通りである。

【0088】

また、先に述べた第1および2の実施形態、並びに下記第3の実施形態におけるように、複数の半導体レーザーをヒートブロック等の支持部材に1列に並べて固定する場合は、各々複数の半導体レーザーを固定したその支持部材を複数積層した構造を採用して、多数の半導体レーザーを2次元的に配列させることができる。

【0089】

以上のようにして多数の半導体レーザーを、レーザービームの照射を受ける側

から見た状態で2次元的に配列すれば、多数の半導体レーザーを高密度に配置できるから、1本のマルチモード光ファイバーにより多数のレーザービームを入射させることができが可能となって、より高出力の合波レーザービームを得ることができる。

【0090】

次に、図11を参照して本発明の第3の実施形態について説明する。この第3実施形態の合波レーザー光源も、互いに同じ波長の複数のレーザービームを合波するようにしたものであり、銅からなるヒートブロック260上に配列固定された8個のチップ状態のGaN系半導体レーザーLD21, LD22, LD23, LD24, LD25, LD26, LD27およびLD28と、合波光学系270とから構成されている。

【0091】

GaN系半導体レーザーLD21～28は、発振波長が例えば全て共通の400nmであり、出力も全て共通の50mWである。そしてこれらのGaN系半導体レーザーLD21, LD22, LD23, LD24, LD25, LD26, LD27およびLD28から発散光状態で出射したレーザービームB21, B22, B23, B24, B25, B26, B27およびB28は、マイクロレンズアレイ261によって平行光化される。

【0092】

このマイクロレンズアレイ261によって平行光とされたレーザービームB21～28は、1つの集光レンズ262によって集光され、マルチモード光ファイバー251のコア251aの一端面上で収束する。マルチモード光ファイバー251は、マイクロレンズアレイ261および集光レンズ262とともに合波光学系270を構成している。すなわち、集光レンズ262によって上述のように集光されたレーザービームB21～28がこのマルチモード光ファイバー251のコア251aに入射してそこを伝搬し、1本のレーザービームB20に合波されてマルチモード光ファイバー251から出射する。

【0093】

この構成においては、マイクロレンズアレイ261の各レンズのNA(開口数)を0.5とし、集光レンズ262による各ビームの集束角 $\alpha = 2.75^\circ$ とすると、レーザ

一ビームB21~28のコア251a上での収束スポット径は約1.4μmとなる。そして、GaN系半導体レーザーLD21~28の出力が全て50mWのとき、合波されたレーザービームB20の出力は400mWとなる。

【0094】

また本実施の形態では、8個のチップ状態のGaN系半導体レーザーLD21~28を、サブマウント9を介してヒートブロック260の上に実装している。この実装も、先に説明した第1の実施の形態と同様になされる。

【0095】

次に、図23、24および25を参照して、本発明の合波レーザー光源に用いられ得るレーザー装置410'について説明する。図23、24および25はそれぞれ、このレーザー装置410'の側面形状、正面形状および平面形状を示すものである。このレーザー装置410'は、シングルキャビティレーザーダイオードチップ412が一例として横に10個並設され、それが上下に2段配置されてなる。つまりここでは、ヒートブロック411の上に別のヒートブロック411'が積み重ねて固定され、各ヒートブロック411および411'にそれぞれ、10個のシングルキャビティレーザーダイオードチップ412と1個の合成樹脂あるいはガラスからなるコリメーターレンズアレイ414とが固定されている。

【0096】

シングルキャビティレーザーダイオードチップ412は、一例としてGaN系レーザーダイオードからなる発振波長が405nmのものであり、各々から出力30mWのレーザービーム412Bが発せられる。

【0097】

一方ヒートブロック411は、レーザーダイオードチップ412を固定する水平なレーザー固定面411aと、レーザーダイオードチップ412を固定した部分よりも前方側（レーザービーム412Bの射出方向）に形成されたレンズ規定面411bと、上記発光点412aから発散光状態で射出されるレーザービーム412Bのケラレを回避する凹部411cとを有している。またヒートブロック411'はヒートブロック411と同様にレーザービーム412Bのケラレを回避する凹部411cを有する他、下段のヒートブロック411に固定されるレーザーダイオードチップ412との干渉を避けるた

めの凹部411dを有している。

【0098】

上記レーザー固定面411aは、平面度が $0.5\mu m$ 以下である高平坦面に加工されている。レーザーダイオードチップ412は、熱拡散性を確保してその温度上昇を抑制するために、それぞれレーザー固定面411aにロウ材を用いて固定される。

【0099】

上記レンズ規定面411bは、レーザーダイオードチップ412の各発光点412aから所定距離離れて、該レーザーダイオードチップ412の発光軸Oに垂直に形成されている。またこのレンズ規定面411bも、平面度が $0.5\mu m$ 以下である高平坦面に加工されている。

【0100】

またコリメーターレンズアレイ414は、10個のコリメーターレンズ414aが一列に一体的に固定されてなるものである。本例において1つのコリメーターレンズ414aは、軸対称レンズの光軸を含む一部を細長く切り取った形状とされ、その焦点距離fは0.9mm、有効高さは1.3mmで、レーザービーム412Bの断面形状に合わせて縦横比が例えば3:1とされている。

【0101】

さらにコリメーターレンズアレイ414は、10個のコリメーターレンズ414aが並んだ部分から左右に張り出した部分を有し、この部分の後方端面は高平坦面に加工されて、ヒートブロック411、411'への取付端面414bとされている。コリメーターレンズアレイ414は、これら2箇所の取付端面414bを前記レンズ規定面411bに接着剤を用いて接着する等により、ヒートブロック411、411'に固定される。

【0102】

その際、レーザーダイオードチップ412の発光軸Oと、各コリメーターレンズ414aの光軸とが一致する状態にコリメーターレンズアレイ414を位置合わせする必要がある。本例の場合は、コリメーターレンズアレイ414の取付端面414bをレンズ規定面411bに押しつけながら、このコリメーターレンズアレイ414をレンズ光軸に垂直な面内で上下左右に動かして、上述の位置合わせを正確かつ簡単に行

うことができる。

【0103】

ヒートブロック411、411'におけるコリメーターレンズアレイ414の固定位置とレンズ規定面411bとの位置関係は、上記のようしてコリメーターレンズアレイ414がヒートブロック411、411'に固定されたとき、各コリメーターレンズ414aの焦点位置がレーザーダイオードチップ412の各発光点412aに来るよう設定されている。そこで、コリメーターレンズアレイ414がヒートブロック411、411'に固定されると、コリメーターレンズ414aの光軸方向位置は、自動的に適正な位置、つまり発散光であるレーザービーム412Bを正確に平行光化する位置に設定されることになる。

【0104】

なおコリメーターレンズアレイ414をヒートブロック411、411'に固定するためには、上記のようにコリメーターレンズアレイ414の取付端面414bをヒートブロック411、411'のレンズ規定面411bに固着する他、それらの面とは異なる面どうしを固着するようにしてもよい。例えば、ヒートブロック411、411'に図21において右方に張り出したマウント部を形成しておき、コリメーターレンズアレイ414の光軸に平行な面、例えば図21中の下端面をそのマウント部の上面に固着してもよい。

【0105】

ここで本例では、ヒートブロック411、411'のレンズ規定面411bが前述の通りの高平坦面とされているので、このヒートブロック411、411'にコリメーターレンズアレイ414を固定する際の該アレイ414の動きを抑制して、正確に上記位置合わせを行うことが可能になる。

【0106】

また、ヒートブロック411、411'のレーザー固定面411aも前述の通りの高平坦面とされているので、レーザーダイオードチップ412をヒートブロック411、411'に固定する際の該チップ412の動きを抑制して、それを正確な位置に固定することができる。

【0107】

以上説明したレーザー装置410'は図21に示されている通り、複数のレーザービーム412Bを1本に合波して、高強度のレーザービームを得るために使用されている。すなわち、このレーザー装置410'のヒートブロック411はベース板421上に固定され、該ベース板421上にはさらに集光レンズ420を保持する集光レンズホルダ422と、マルチモード光ファイバー430の入射端部を保持するファイバーホルダ423とが固定されている。

【0108】

上記の構成において、コリメーターレンズアレイ414の各コリメーターレンズ414aによって平行光とされた10本（上下で合計20本）のレーザービーム412Bは、集光レンズ420によって集光され、マルチモード光ファイバー430のコア（図示せず）の入射端面上で収束する。これらのレーザービーム412Bはマルチモード光ファイバー430のコアに入射してそこを伝搬し、1本のレーザービームに合波されてマルチモード光ファイバー430から出射する。なおマルチモード光ファイバー430としては、ステップインデックス型のもの、グレーデッドインデックス型のもの、およびそれらの複合型のものが全て適用可能である。

【0109】

本例において、集光レンズ420は幅が6mm、有効高さが1.8mm、焦点距離が14mmのレンズである。またマルチモード光ファイバー430はコア径が50μm、NA（開口数）が0.2のものである。20本のレーザービーム412Bは集光レンズ420により集光されて、マルチモード光ファイバー430のコア端面に集光スポット径約30μmで収束する。これらのレーザービーム412Bのファイバー結合における損失、およびコリメーターレンズ414a並びに集光レンズ420を透過する際の損失の合計は20%である。その場合、各レーザービーム412Bの出力が30mWであるならば、480mWの高出力、高輝度の合波レーザービームが得られることになる。

【0110】

なお、上記と同じ構成のレーザーダイオードチップ412を10個並設し、それらを上下に3段積み上げた構成にすれば、720mWの高出力、高輝度の合波レーザービームを得ることができる。

【0111】

次に図12～16を参照して、図3～5に示した紫外光高輝度合波ファイバーモジュールを利用した画像露光装置について説明する。

【0112】

図12は、この画像露光装置110Aの全体形状を示すものである。図示の通りこの画像露光装置110Aは、複数のレーザービームを生成する光源ユニット120と、光源ユニット120で生成された複数のレーザービームを集光する露光ヘッド130と、露光ヘッド130を副走査方向に沿って移動させる露光ヘッド移動部140と、画像が記録される記録媒体Fが装着されかつ該記録媒体Fが主走査方向に移動するよう図12の矢印R方向に回転駆動されるドラム150と、主として光源ユニット120の冷却用の風（以下、「冷却風」という。）を生成する冷却用プロア160とを含んで構成されている。

【0113】

なお記録媒体Fは、ドラム150に巻き付けることができる可撓性記録材料であって、具体的には感光もしくは感熱性のフィルム、感光もしくは感熱性の印刷用刷版等である。また、このように記録媒体Fをドラム150に巻き付ける形態ではなく、ドラム150自体が感光もしくは感熱性を有する場合にも、本発明は同様に適用可能である。

【0114】

光源ユニット120には、図3～5に示した紫外光高輝度合波ファイバーモジュール（以下、単に合波ファイバーモジュールという）121が表面に配置され、裏面に放熱フィン123（図13も参照）が設けられた光源基板124と、光源基板124の一端部に垂直に取り付けられると共にSC型光コネクタ125Aのアダプタが複数（合波ファイバーモジュール121と同数）設けられたアダプタ基板125と、光源基板124の他端部に水平に取り付けられると共に記録媒体Fに記録する画像の画像データに応じて合波ファイバーモジュール121を駆動するLDドライバー回路126（図15も参照）が設けられたLDドライバー基板127とが備えられている。

【0115】

合波ファイバーモジュール121に接続された光ファイバー30の他端部には各々

SC型光コネクタ125Aのプラグが設けられており、該プラグはアダプタ基板125に設けられたアダプタの一方の挿入口に嵌合されている。したがって、各合波ファイバーモジュール121から射出されたレーザービームは光ファイバー30によつて、アダプタ基板125に設けられているアダプタの略中央位置まで伝送される。

【0116】

また、LDドライバー基板127に設けられているLDドライバー回路126における合波ファイバーモジュール121の駆動用信号の出力端子は合波ファイバーモジュール121に個別に接続されており、各合波ファイバーモジュール121は、LDドライバー回路126によって各々個別に駆動が制御される。

【0117】

一方、露光ヘッド130には、上記複数の合波ファイバーモジュール121から射出された各レーザービームBを取りまとめて射出するファイバーアレイ部131が備えられている。このファイバーアレイ部131には、各々アダプタ基板125に設けられた複数のアダプタの他方の挿入口に、一端部に設けられたSC型光コネクタのプラグが嵌合された複数のマルチモード光ファイバー170によって、各合波ファイバーモジュール121から射出されたレーザービームBが伝送される。

【0118】

図14には、ファイバーアレイ部131を図12の矢印A方向に見た状態が示されている。同図に示すようにこのファイバーアレイ部131は、各々片面に合波ファイバーモジュール121の数の半数のV字溝が相隣接して設けられた2枚の基台131Aが、上記V字溝が対向するように配置されると共に、各V字溝に対して各光ファイバー170の他端部が1本ずつ嵌め込まれて構成されている。したがって、ファイバーアレイ部131からは、各合波ファイバーモジュール121から射出された複数のレーザービームが所定間隔ごとに同時に射出されることになる。

【0119】

また、図12に示すように露光ヘッド130には、ファイバーアレイ部131側より、コリメータレンズ132、開口部材133、および結像レンズ134が順に配列されている。なお開口部材133は、開口部がファイバーアレイ部131のレーザービーム出射口からみてファーフィールド(far field)の位置となるように配置されてい

る。これによって、ファイバーアレイ部131における複数の光ファイバー170の出射端から出射された全てのレーザービームBに対して同等の光量制限効果を与えることができる。

【0120】

一方、露光ヘッド移動部140には、長手方向が副走査方向に沿うように配置されたボールネジ141および2本のレール142が備えられており、ボールネジ141を回転駆動する副走査モータ143（図15も参照）を作動させることによって、一部がボールネジ141に螺合された露光ヘッド130を、レール142に案内された状態で副走査方向に移動させることができる。

【0121】

また、ドラム150は主走査モータ151（図15も参照）を作動させることによって図12の矢印R方向に回転され、これによって主走査がなされる。

【0122】

一方、冷却用プロア160は、図12および図13に示すように、該冷却用プロア160によって生成された冷却風の風向きが、光源基板124に設けられた放熱フィン123および全ての光ファイバー30の双方に当る方向となるように配置されている。したがって、冷却用プロア160により生成された冷却風によって、各合波ファイバーモジュール121の駆動時における温度上昇を抑制することができると共に、各光ファイバー30を強制的に振動させることができる。

【0123】

次に図15を参照して、この画像露光装置110Aの制御系の構成について説明する。同図に示すように該制御系は、画像データに応じて各合波ファイバーモジュール121を駆動するLDドライバ回路126と、主走査モータ151を駆動する主走査モータ駆動回路181と、副走査モータ143を駆動する副走査モータ駆動回路182と、冷却用プロア160を駆動する冷却用プロア駆動回路183と、LDドライバ回路126、主走査モータ駆動回路181、副走査モータ駆動回路182および冷却用プロア駆動回路183を制御する制御回路180とを備えている。ここで制御回路180には、記録媒体Fに記録する画像を示す画像データが供給される。

【0124】

次に、以上のように構成された画像露光装置110Aの作用について、図16に示すフローチャートを参照しつつ説明する。なお図16は、画像露光装置110Aによって画像記録を行う際の処理の流れを示すフローチャートである。

【0125】

まず、記録媒体Fに記録する画像を担持した画像データを、画像記録に際して該画像の画像データを一時的に記憶する不図示の画像メモリから制御回路180に転送する（ステップS100）。制御回路180は、転送されてきた画像データ、および記録画像の予め定められた解像度を示す解像度データに基づいて調整された信号をLDドライバー回路126、主走査モータ駆動回路181、および副走査モータ駆動回路182に供給する。

【0126】

次いで制御回路180は、冷却用プロア160の駆動を開始するように冷却用プロア駆動回路183を制御する（ステップS102）。これにより、冷却用プロア160によって生成された冷却風による各合波ファイバーモジュール121の冷却動作が開始されると共に、各光ファイバー30の振動が開始される。

【0127】

ここで、各光ファイバー30の振動を、光ファイバー30から出射された光の光量変動を1主走査時間の間にランダム化させることができる振動とすることによって、記録媒体F上に記録される画像のむらを低減することができる。そこで本実施の形態では、このような振動とすることができる風量で、かつ本来の目的である放熱フィン123の冷却に必要とされる風量を実験やコンピュータ・シミュレーション等によって予め得ておき、この風量となるように冷却用プロア駆動回路183が冷却用プロア160の駆動を制御している。

【0128】

次に主走査モータ駆動回路181は、制御回路180から供給された信号に基づいて上記解像度データに応じた回転速度でドラム150を図12の矢印R方向に回転させるように主走査モータ151を制御し（ステップS104）、副走査モータ駆動回路182は、上記解像度データに応じて副走査モータ143による露光ヘッド130の副走査方向に対する送り間隔を設定する（ステップS106）。

【0129】

次にLDドライバー回路126は、画像データに応じて各合波ファイバーモジュール121の駆動を制御する（ステップS108）。

【0130】

各合波ファイバーモジュール121から射出されたレーザービームBは、光ファイバー30、SC型光コネクタ125A、および光ファイバー170を介してファイバーアレイ部131から出射され、コリメータレンズ132によって平行光束とされた後、開口部材133によって光量が制限され、結像レンズ134を介してドラム150上の記録媒体Fに集光される。

【0131】

この場合、記録媒体Fには、各合波ファイバーモジュール121から射出された複数のレーザービームBに応じて複数のビームスポットが形成される。これらのビームスポットにより、露光ヘッド130が上記ステップS106で設定された送り間隔のピッチで副走査方向に送られると共に、上記ステップS104により開始されたドラム150の回転によって、解像度が上記解像度データによって示される解像度となる2次元画像が記録媒体F上に露光、記録される（ステップS110）。

【0132】

記録媒体F上への2次元画像の記録が終了すると、主走査モータ駆動回路181は主走査モータ151の回転駆動を停止し（ステップS112）、制御回路180は冷却用プロア160の駆動を停止するように冷却用プロア駆動回路183を制御し（ステップS114）、その後に本処理を終了する。

【0133】

本処理によって、記録媒体Fへの所定解像度による2次元画像の記録がなされると共に、この画像記録の間には冷却用プロア160が駆動されるので、光ファイバー30がランダムに振動され、光ファイバー30を伝搬するレーザービームに対して白色ノイズ的な雑音を重畠させることができ、その結果、記録された2次元画像にs w a t hむらやビートむら等の画像むらが発生することを防止できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施の形態による合波レーザー光源を示す平面図

【図2】

上記合波レーザー光源を構成する半導体レーザーの部分を示す斜視図

【図3】

上記合波レーザー光源を備えた紫外光高輝度合波ファイバーモジュールを示す平面図

【図4】

上記紫外光高輝度合波ファイバーモジュールの側面図

【図5】

上記紫外光高輝度合波ファイバーモジュールの部分正面図

【図6】

上記合波レーザー光源に用いられたコリメーターレンズの側面図(1)と正面図(2)

【図7】

上記合波レーザー光源に用いられた集光レンズの側面図(1)と正面図(2)

【図8】

上記合波レーザー光源を複数用いる光源装置の斜視図

【図9】

本発明の第2の実施の形態による合波レーザー光源を示す平面図

【図10】

上記合波レーザー光源に用いられた半導体レーザーにおける発光点移動量を、
従来の半導体レーザーにおける発光点移動量と比較して示すグラフ

【図11】

本発明の第3の実施の形態による合波レーザー光源を示す平面図

【図12】

本発明の一実施の形態による露光装置の斜視図

【図13】

上記露光装置の一部を示す斜視図

【図14】

上記露光装置の一部を示す正面図

【図15】

上記露光装置の電気的構成を示すブロック図

【図16】

上記露光装置における画像露光に関わる処理の流れを示すフローチャート

【図17】

図1の合波レーザー光源に用いられた半導体レーザーの実装構造を示す正面図

【図18】

図17の構造の一部を示す斜視図

【図19】

図1の合波レーザー光源に用いられた半導体レーザーにおけるサブマウントの熱膨張係数と、発光点に作用する応力との関係を示すグラフ

【図20】

図1の合波レーザー光源に用いられた半導体レーザーにおけるサブマウントの熱膨張係数と、発光点に作用する応力との関係を示すグラフ

【図21】

本発明の合波レーザー光源に用いられ得るレーザー装置の側面図

【図22】

図21のレーザー装置の正面図

【図23】

図21のレーザー装置の平面図

【符号の説明】

9 サブマウント

10 ヒートブロック

11~17 コリメーターレンズ

20 集光レンズ

30 マルチモード光ファイバー

30a マルチモード光ファイバーのコア

50 コリメーターレンズアレイ

110A 画像露光装置

120 光源ユニット

121 合波ファイバーモジュール

130 露光ヘッド

140 露光ヘッド移動部

150 ドラム

170 マルチモード光ファイバー

250 合波光学系

251 マルチモード光ファイバー

261 マイクロレンズアレイ

262 集光レンズ

270 合波光学系

410' レーザー装置

412 レーザーダイオードチップ

504、506、509 Au/Pt/Ti メタライズ層

505、508 Au/Ni メッキ層

507、511 共晶点AuSn半田

LD1~7、LD11~15、LD21~28 GaN系半導体レーザー

B1~7、B11~15、B21~28 レーザービーム

B、B10、B20 合波されたレーザービーム

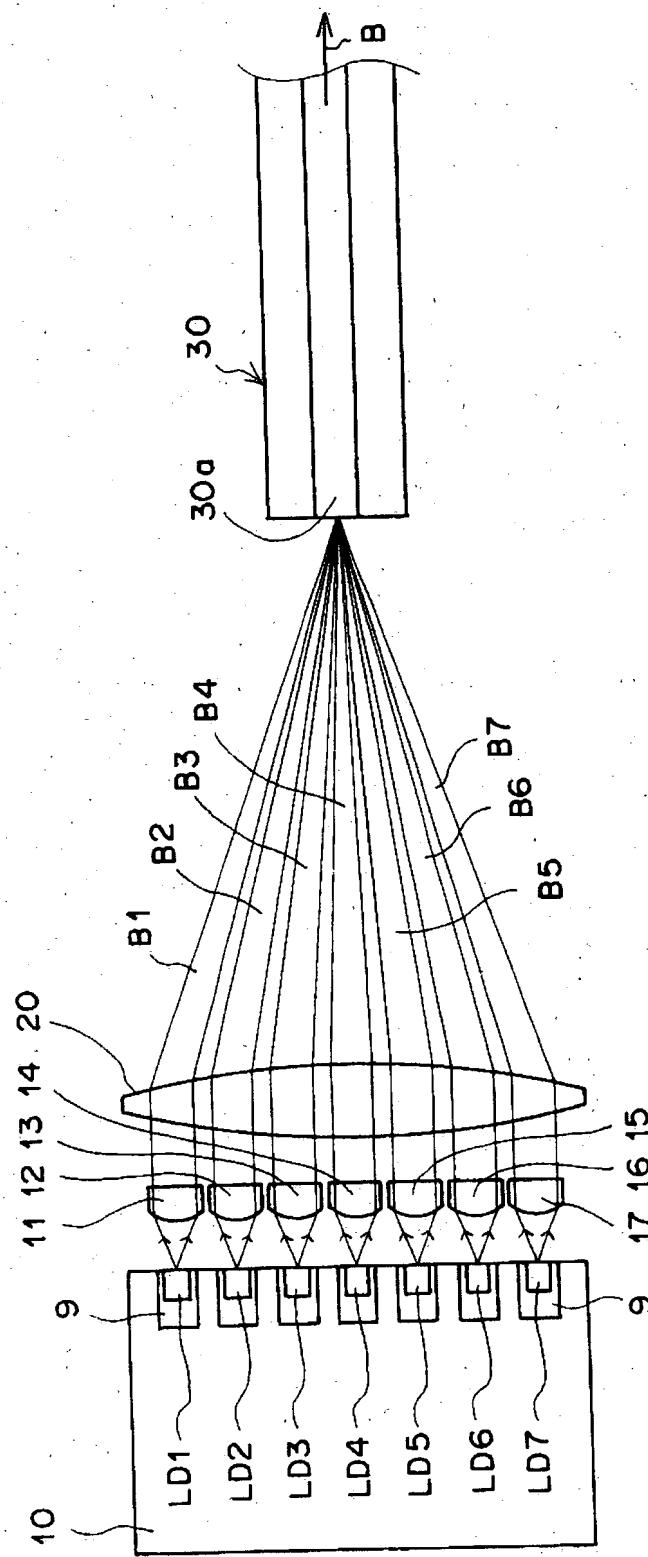
F 記録媒体

H11~15 集光レンズ

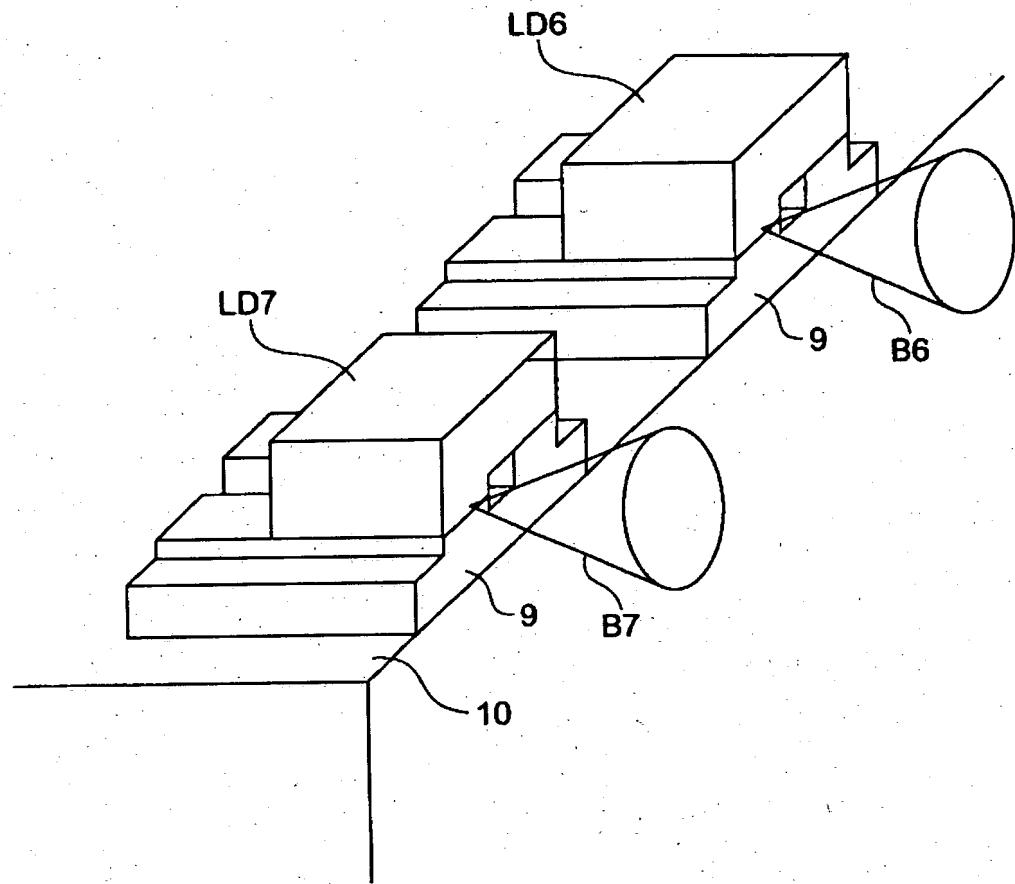
【書類名】

図面

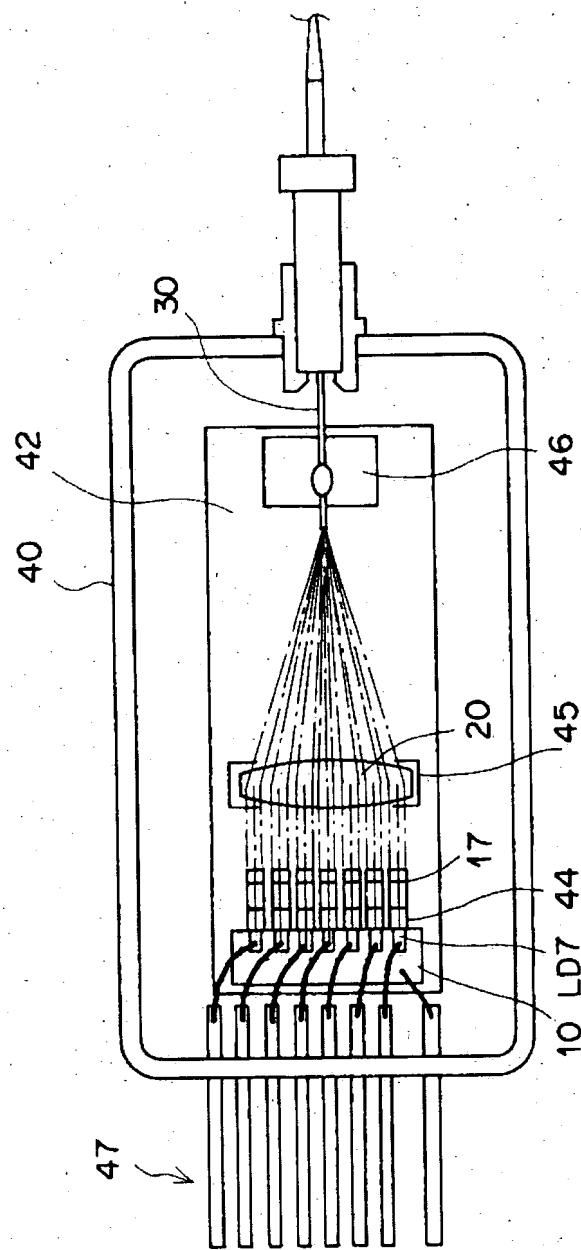
【図1】



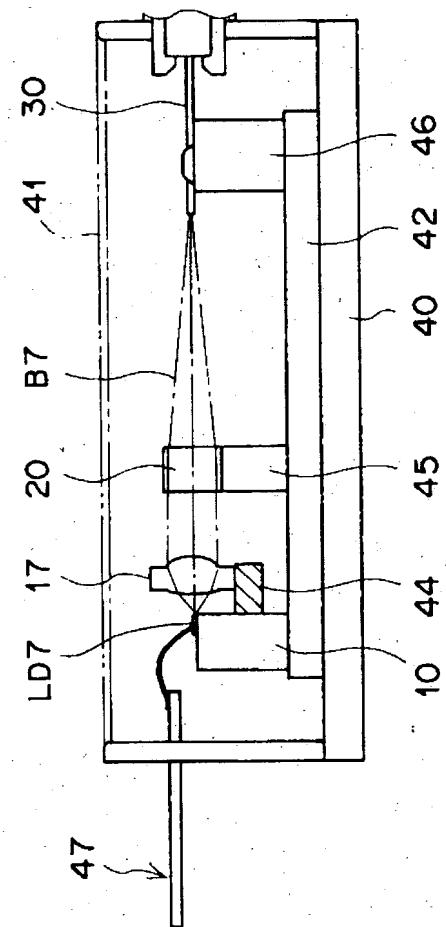
【図2】



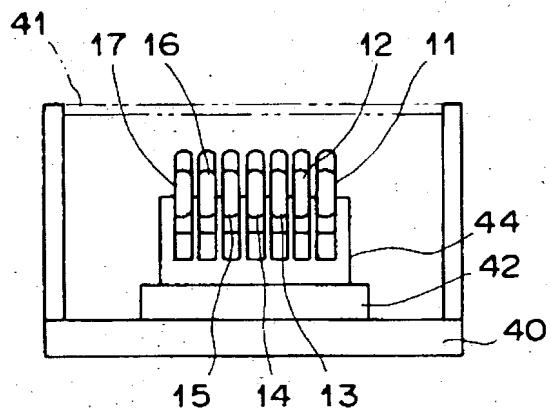
【図3】



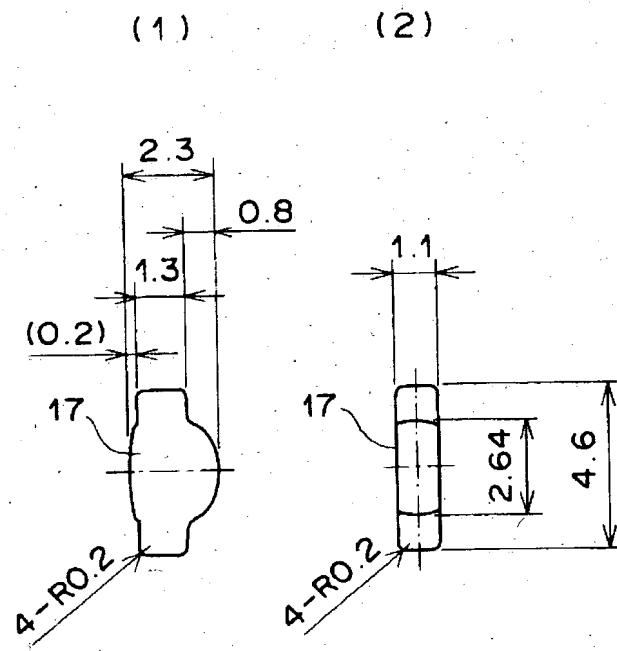
【図4】



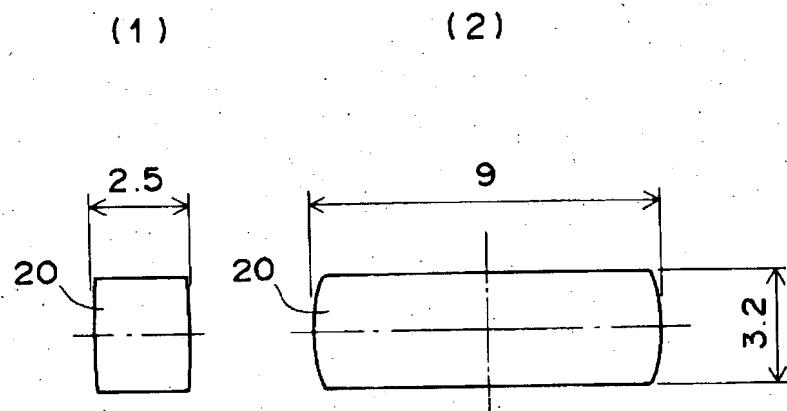
【図5】



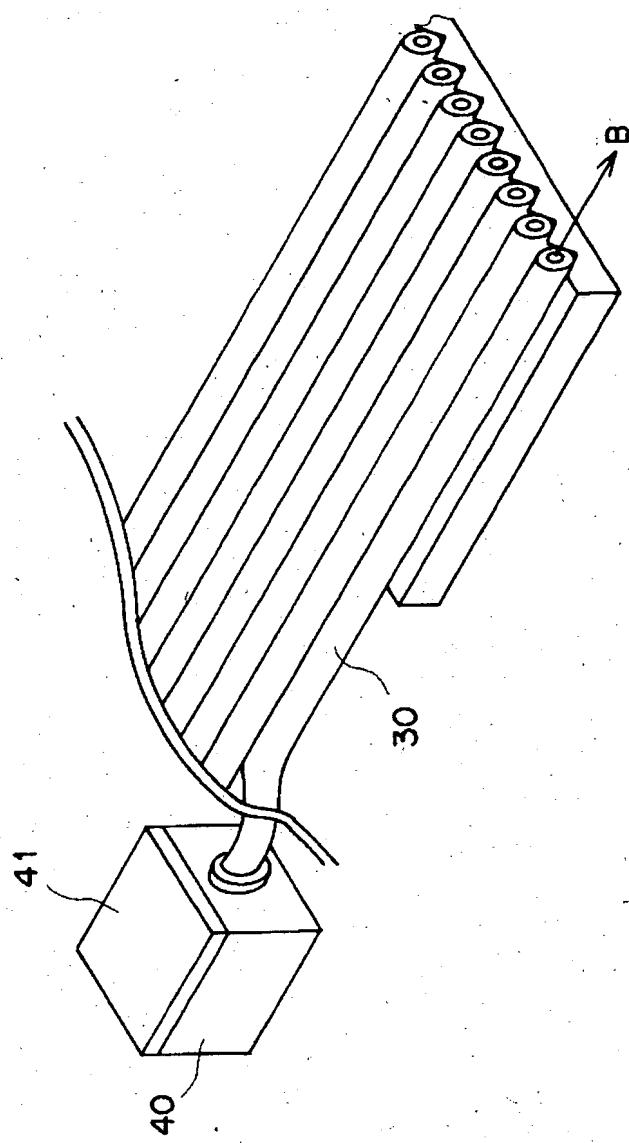
【図6】



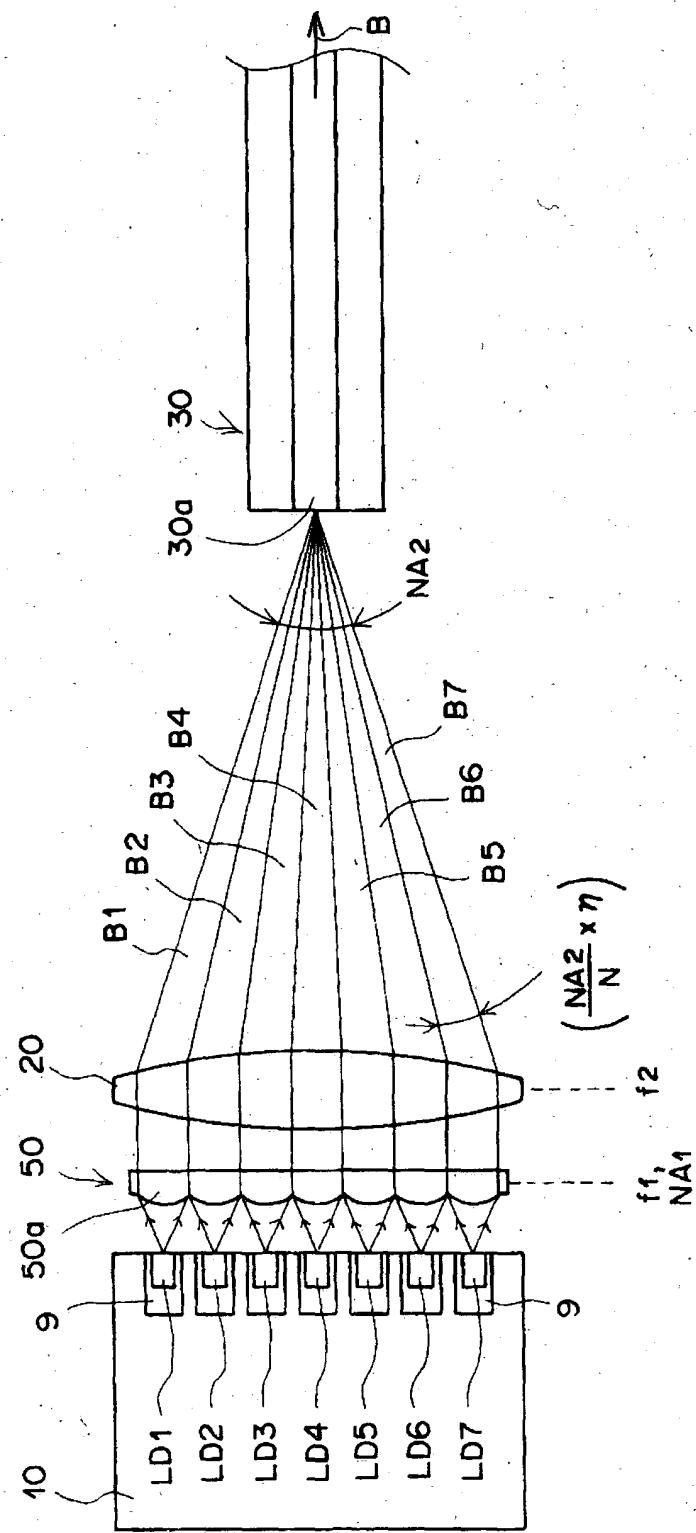
【図7】



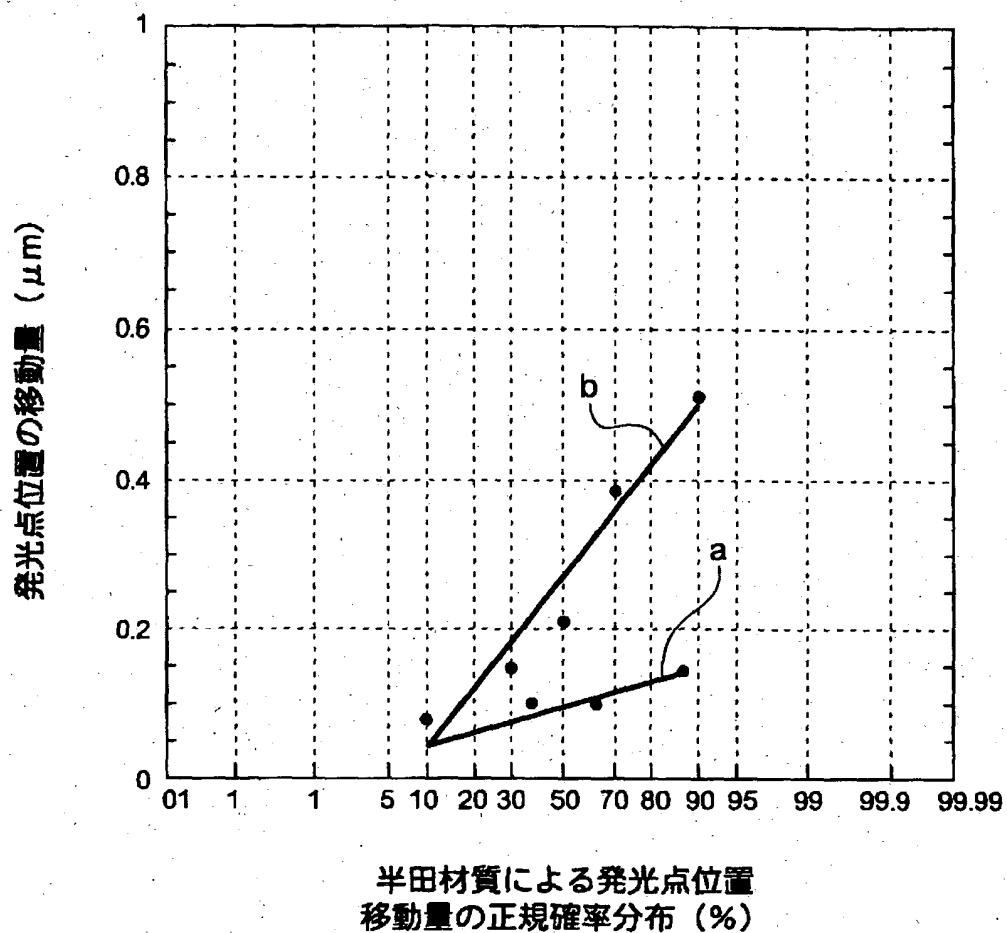
【図8】



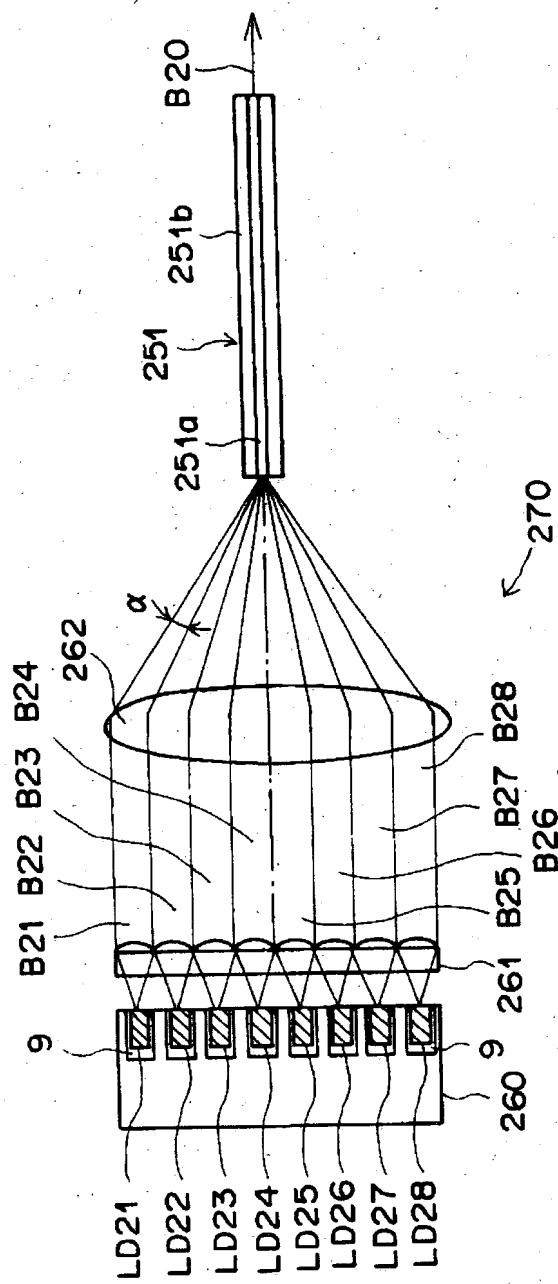
【図9】



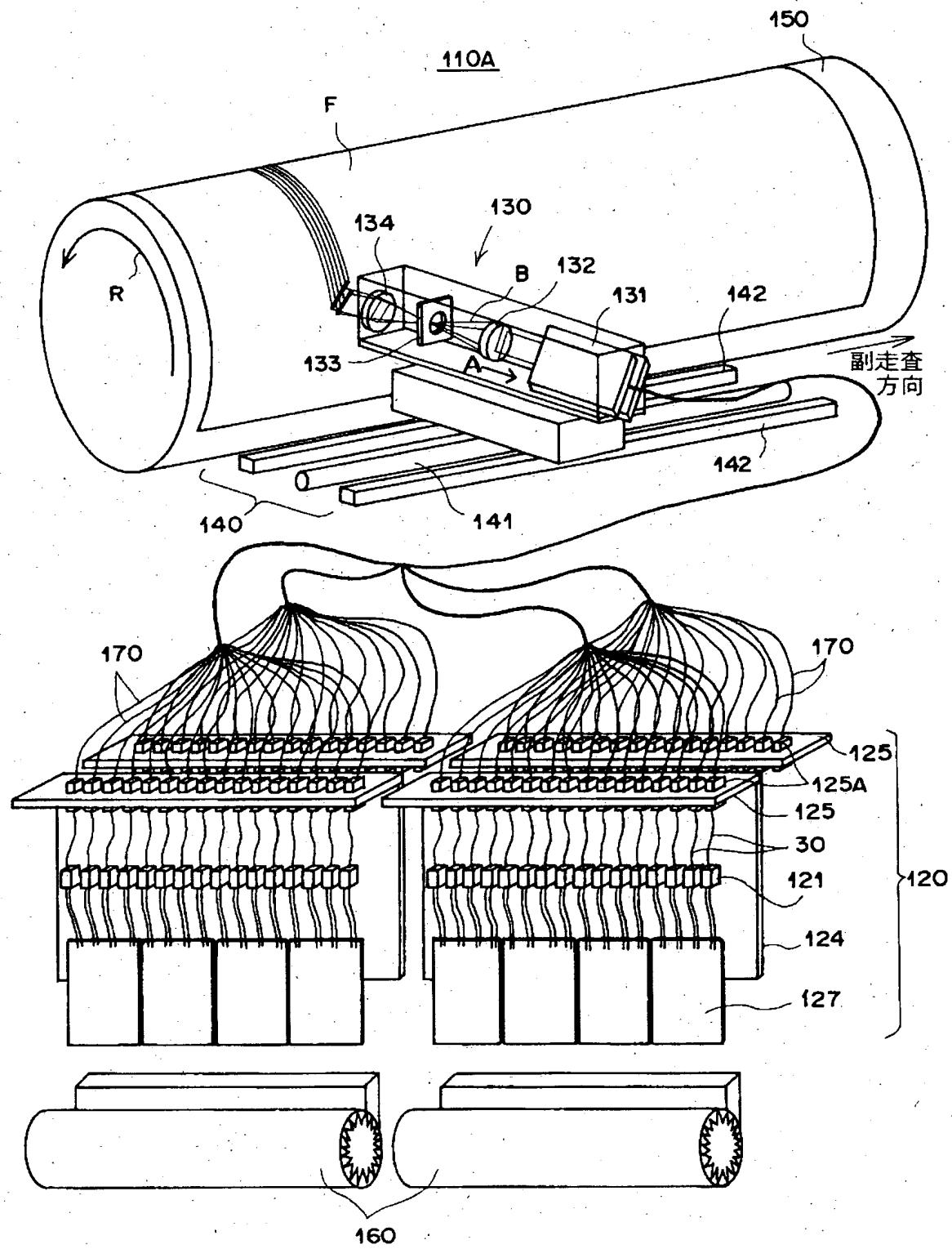
【図10】



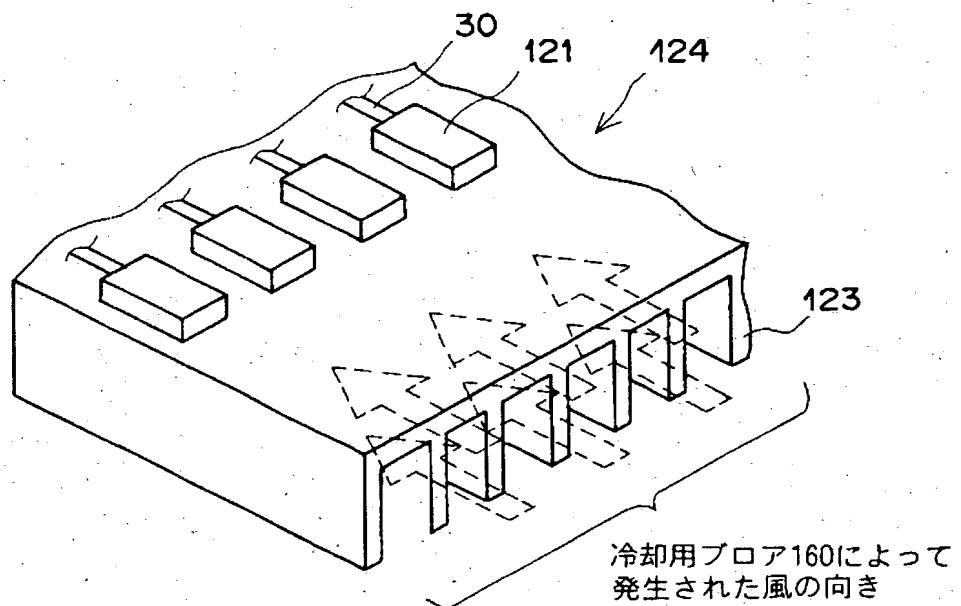
【図11】



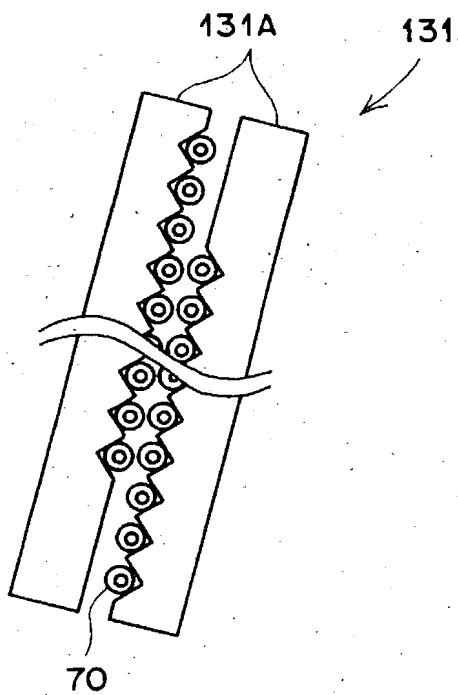
【図12】



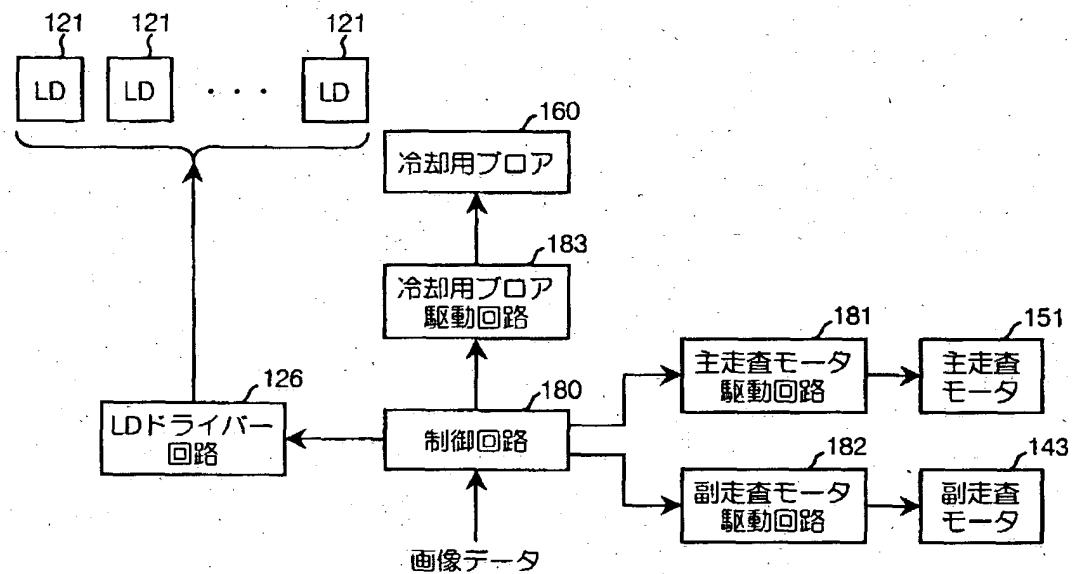
【図13】



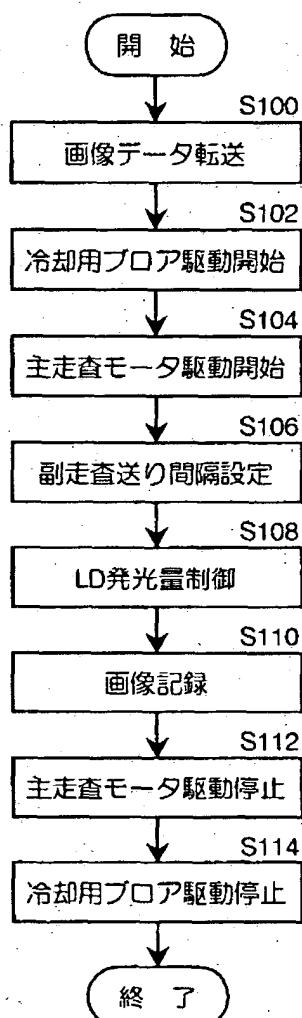
【図14】



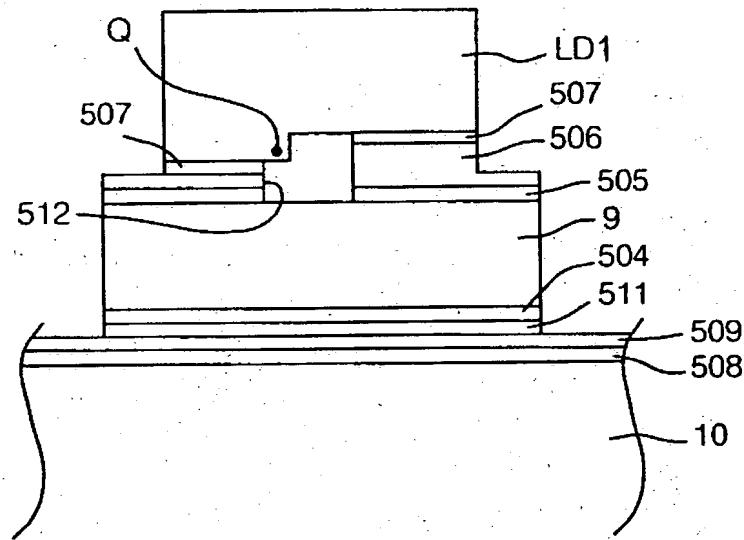
【図15】



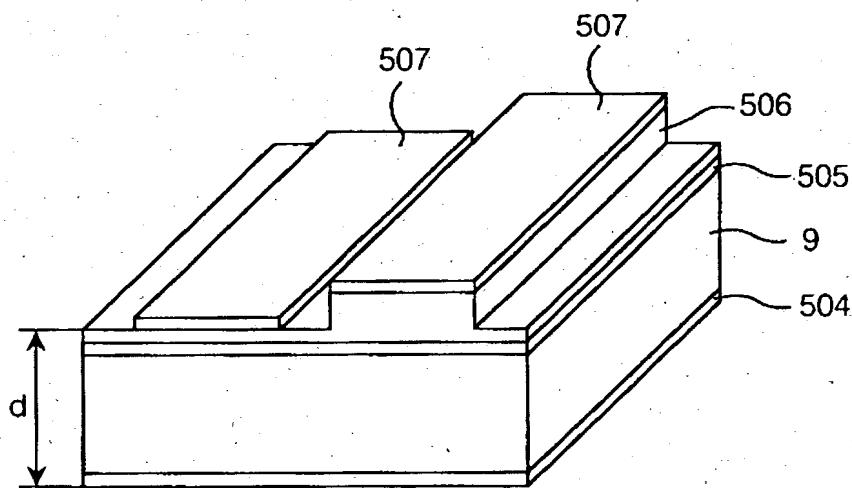
【図16】



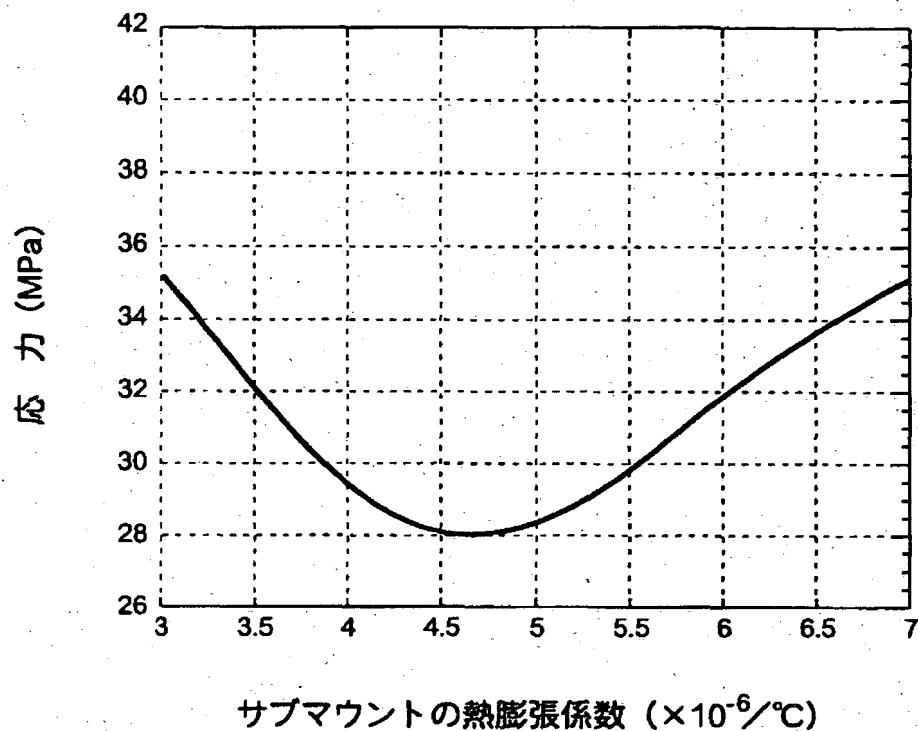
【図17】



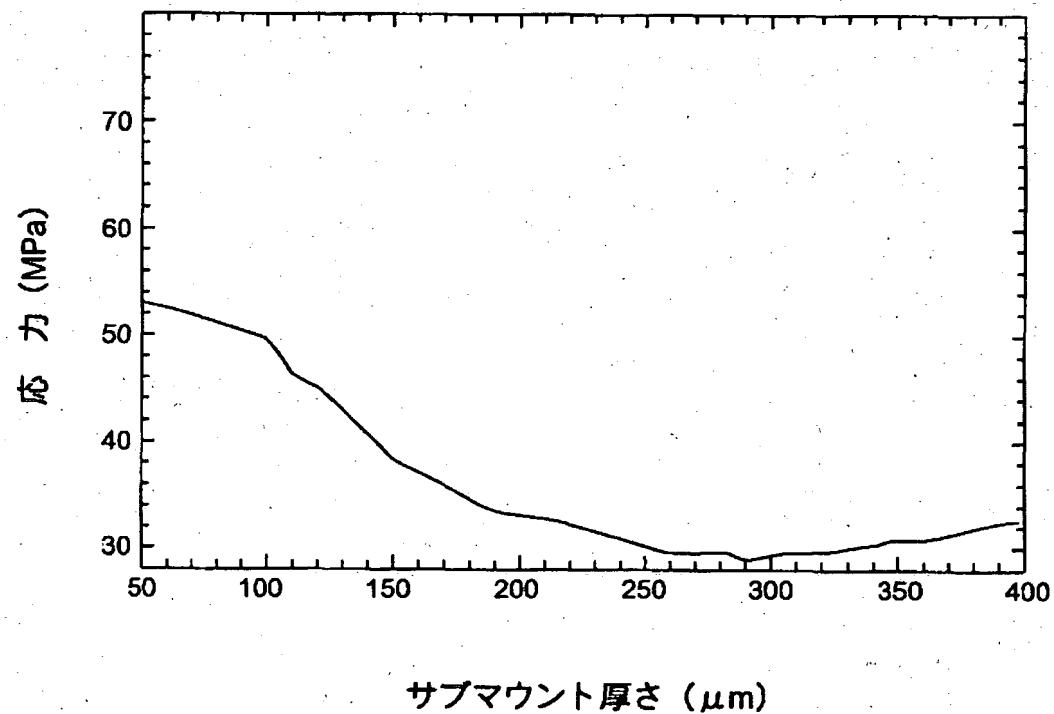
【図18】



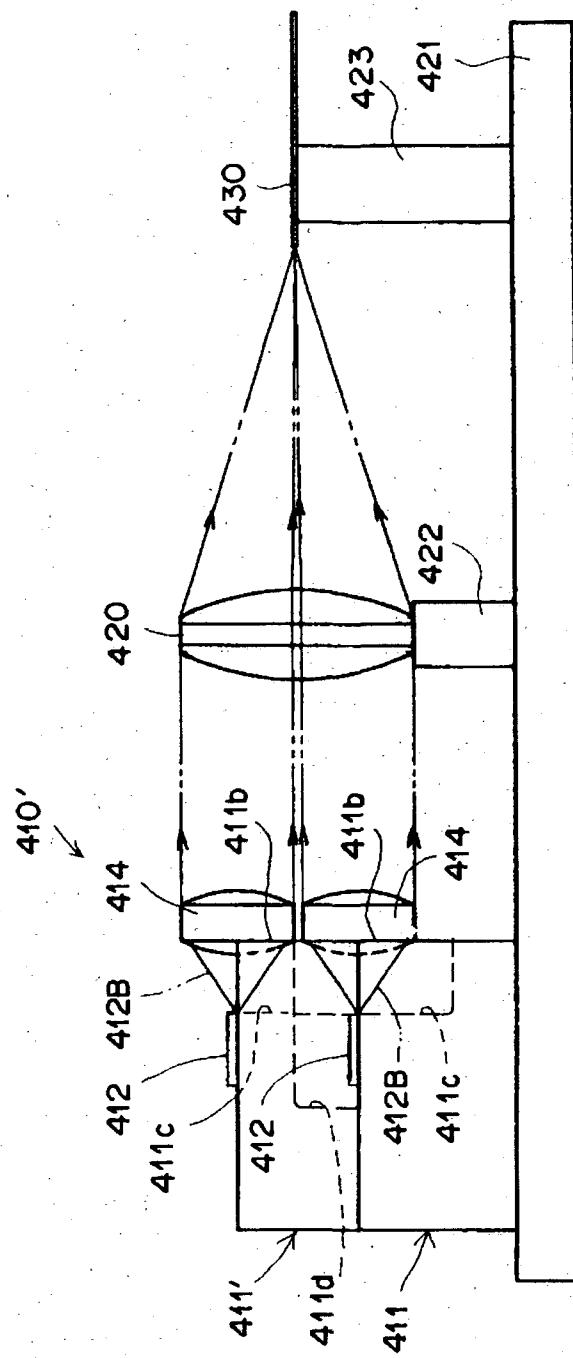
【図19】



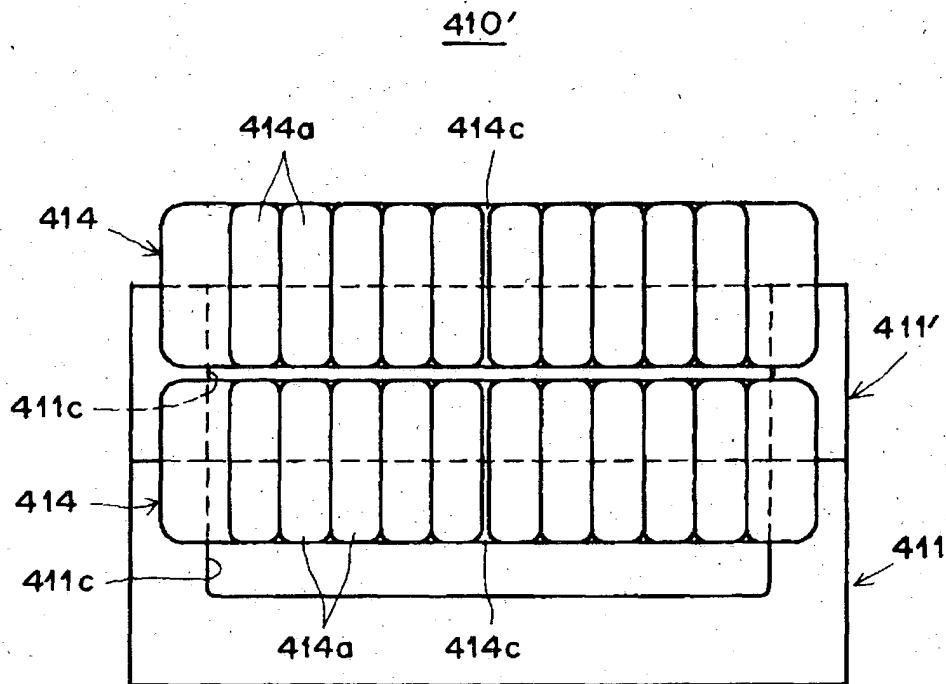
【図20】



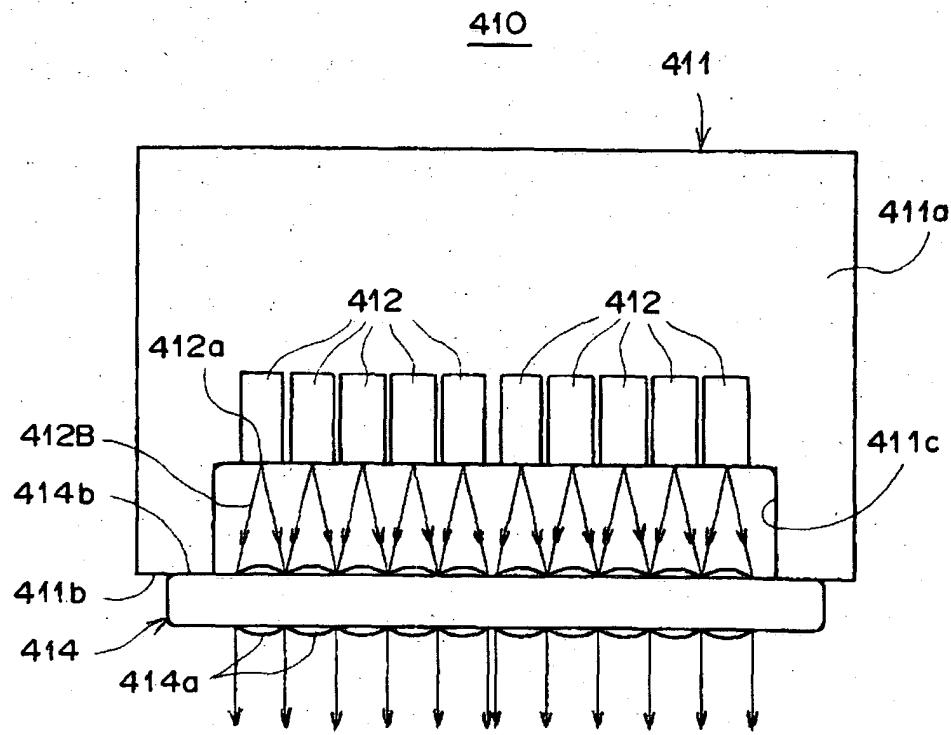
【図21】



【図22】



【図23】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高出力が得られる低コストの合波レーザー光源を得る。

【解決手段】 複数の半導体レーザーLD1～7からそれぞれ出射したレーザービームB1～7を、例えばコリメーターレンズ11～17および集光レンズ20からなる集光光学系で集光した上でマルチモード光ファイバー30に結合させて合波する。そして半導体レーザーとして、チップ状態のシングルキャビティ窒化物系化合物半導体レーザーLD1～7を用い、それらをサブマウント9を介してCuまたはCu合金製放熱ブロック10上に実装する。またサブマウント9は熱膨張係数が $3.5\sim6.0\times10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ である材料を用いて200～400 μm の厚さに形成し、このサブマウント9に対して半導体レーザーLD1～7は、両者の接着面内でAuSn共晶点半田およびメタライズ層を複数に分割して、ジャンクションダウン構造で分割接着する。

【選択図】 図1

認定・付加情報

特許出願の番号	特願2002-201904
受付番号	50201012906
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0091
作成日	平成14年 7月11日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成14年 7月10日

【特許出願人】

【識別番号】 000005201

【住所又は居所】 神奈川県南足柄市中沼210番地

【氏名又は名称】 富士写真フィルム株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】 100073184

【住所又は居所】 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3 新横

浜K Sビル 7階

【氏名又は名称】 柳田 征史

【選任した代理人】

【識別番号】 100090468

【住所又は居所】 神奈川県横浜市港北区新横浜3-18-3 新横

浜K Sビル 7階

【氏名又は名称】 佐久間 剛

出願人履歴情報

識別番号 [000005201]

1. 変更年月日 1990年 8月14日

[変更理由] 新規登録

住 所 神奈川県南足柄市中沼210番地
氏 名 富士写真フィルム株式会社